(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002—311590

(P2002-311590A) (43)公開日 平成14年10月23日(2002.10.23)

| (51) Int. Cl. 7 | 識別記号 | FI | | テーマコード(参考) |
|-----------------|------|------------|-----|------------|
| G03F 7/039 | 601 | G03F 7/039 | 601 | 2H025 |
| C08F220/18 | | C08F220/18 | | 4J100 |
| G03F 7/004 | 501 | G03F 7/004 | 501 | |
| H01L 21/027 | | H01L 21/30 | 502 | R |

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全61頁)

(21)出願番号 特願2001-113462(P2001-113462)

(22) 出願日 平成13年4月12日(2001.4.12)

(71)出願人 000004178

ジェイエスアール株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24号

(72)発明者 山本 將史

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 石田 英光

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(74)代理人 100100985

弁理士 福沢 俊明

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】感放射線性樹脂組成物

(57) 【要約】

【課題】 特に、ライン・アンド・スペースパターンのスペース幅が広い場合にも、微細なラインパターンを形成でき、しかも放射線に対する透明性、感度、解像度等にも優れた感放射線性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】(A)(メタ)アクリル酸中のカルボキシル基の水素原子を下記式(1)、式(2)または式

(3) (R^{i} 、 R^{i} および R^{i} は水素原子または低級アルキル基; Xはメチレン基、-O-または-S-; aは $1\sim5$) で表される基等で置換した化合物に由来する繰返し単位と、(メタ)アクリル酸 2-メチル-2-アダマンチル等に由来する繰返し単位とを含有する、酸の作用によりアルカリ可溶性を示すアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、(B)感放射線性酸発生剤、並びに(C) t-ブトキシカルボニル基等の官能基を有する多環式化合物を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【化1】

$$(1)$$
 (2) (3)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)下記一般式(1)に示す繰り返し単位(I-1)、繰返し単位(I-2)および繰返し単位(I-3)の群から選ばれる少なくとも1種の繰返し単位と、下記一般式(2)に示す繰返し単位(II)とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶性を示すアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、(B)感放射線性酸発生剤、並びに(C)式-COOR。[式中、R。は水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20の直鎖

状もしくは分岐状のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 $3\sim20$ の 1 価の脂環式炭化水素基または-CH、 $COOR^{10}$ (但し、 R^{10} は水素原子、置換もしくは非置換の炭素数 $1\sim20$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または置換もしくは非置換の炭素数 $3\sim20$ の 1 価の脂環式炭化水素基である。)を示す。〕で表される基を有する分子量 1、000 以下の多環式化合物を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【化1】

〔一般式 (1) において、 R^1 、 R^3 および R^4 は相互 20 に独立に水素原子またはメチル基を示し、 R^4 、 R^4 および R^4 は相互に独立に水素原子または炭素数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、Xはメチレン基、酸素原子または硫黄原子を示し、aは $1\sim5$ の整数である。〕

【化2】

「一般式(2)において、R'は水素原子またはメチル基を示し、各R*は相互に独立に炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、または炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、且40つR*の少なくとも1つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2つのR*が相互の結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成して、残りのR*が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体である。]

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組 50 は、カルポン酸の t - プチルエステル基またはフェノー

20 成物に関わり、さらに詳しくは、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザーあるいはF, エキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線の如き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型レジストとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加 工の分野においては、より高い集積度を得るために、最 近では0.20μm以下のレベルでの微細加工が可能な 30 リソグラフィー技術が必要とされている。しかし、従来 のリソグラフィープロセスでは、一般に放射線としてi 線等の近紫外線が用いられているが、この近紫外線で は、サブクオーターミクロンレベルの微細加工が極めて 困難であると言われている。そこで、0.20μm以下 のレベルでの微細加工を可能とするために、より波長の 短い放射線の利用が検討されている。このような短波長 の放射線としては、例えば、水銀灯の輝線スペクトル、 エキシマレーザーに代表される遠紫外線、X線、電子線 等を挙げることができるが、これらのうち、特にK r F エキシマレーザー (波長248nm)、ArFエキシマ レーザー (波長193nm) あるいはF, エキシマレー ザー(波長157nm)が注目されている。このような エキシマレーザーによる照射に適したレジストとして、 酸解離性官能基を有する成分と放射線の照射(以下、

「露光」という。)により酸を発生する成分(以下、「感放射線性酸発生剤」という。)とによる化学増幅効果を利用したレジスト(以下、「化学増幅型レジスト」という。)が数多く提案されている。化学増幅型レジストとしては、例えば、特公平2-27660号公報には、カルボン酸のナープチルエステル其またはフェノー

ルの t ープチルカーボナート基を有する重合体と感放射 線性酸発生剤とを含有するレジストが提案されている。 このレジストは、露光により発生した酸の作用により、 重合体中に存在する t - プチルエステル基あるいは t -ブチルカーボナート基が解離して、該重合体がカルボキ シル基あるいはフェノール性水酸基からなる酸性官能基 を有するようになり、その結果、レジスト被膜の露光領 域がアルカリ現像液に易溶性となる現象を利用したもの である。

【0003】ところで、従来の化学増幅型レジストの多 10 くは、フェノール系樹脂をベースにするものであるが、 このような樹脂の場合、放射線として遠紫外線を使用す ると、樹脂中の芳香族環に起因して遠紫外線が吸収され るため、露光された遠紫外線がレジスト被膜の下層部ま で十分に到達できないという欠点があり、そのため露光 量がレジスト被膜の上層部では多く、下層部では少なく なり、現像後のレジストパターンが上部が細く下部にい くほど太い台形状になってしまい、十分な解像度が得ら れないなどの問題があった。その上、現像後のレジスト パターンが台形状となった場合、次の工程、即ちエッチ 20 ングやイオンの打ち込みなどを行う際に、所望の寸法精 度が達成できず、問題となっていた。しかも、レジスト パターン上部の形状が矩形でないと、ドライエッチング によるレジストの消失速度が速くなってしまい、エッチ ング条件の制御が困難になる問題もあった。一方、レジ ストパターンの形状は、レジスト被膜の放射線透過率を 高めることにより改善することができる。例えば、ポリ メチルメタクリレートに代表される (メタ) アクリレー ト系樹脂は、遠紫外線に対しても透明性が高く、放射線 透過率の観点から非常に好ましい樹脂であり、例えば特 30 配合することにより、露光から露光後の加熱処理までの 開平4-226461号公報には、メタクリレート系樹 脂を使用した化学増幅型レジストが提案されている。し かしながら、この組成物は、微細加工性能の点では優れ ているものの、芳香族環をもたないため、ドライエッチ ング耐性が低いという欠点があり、この場合も高精度の エッチング加工を行うことが困難であり、放射線に対す る透明性とドライエッチング耐性とを兼ね備えたものと は言えない。

【0004】また、化学増幅型レジストについて、放射 線に対する透明性を損なわないで、ドライエッチング耐 40 性を改善する方策の一つとして、レジスト中の樹脂成分 に、芳香族環に代えて脂肪族環を導入する方法が知られ ており、例えば特開平7-234511号公報には、脂 肪族環を有する(メタ)アクリレート系樹脂を使用した 化学増幅型レジストが提案されている。しかしながら、 このレジストでは、樹脂成分が有する酸解離性官能基と して、従来の酸により比較的解離し易い基(例えば、テ トラヒドロピラニル基等のアセタール系官能基)や酸に より比較的解離し難い基(例えば、tープチルエステル 基、tープチルカーボネート基等のtープチル系官能

基)が用いられており、前者の酸解離性官能基を有する 樹脂成分の場合、レジストの基本物性、特に感度やパタ ーン形状は良好であるが、組成物としての保存安定性に 難点があり、また後者の酸解離性官能基を有する樹脂成 分では、逆に保存安定性は良好であるが、レジストの基 本物性、特に感度やパターン形状が損なわれるという欠 点がある。さらに、このレジスト中の樹脂成分には脂肪 族環が導入されているため、樹脂自体の疎水性が非常に 高くなり、基板に対する接着性の面でも問題があった。 また、化学増幅型レジストを用いてレジストパターンを 形成する際には、酸解離性官能基の解離を促進するた め、通常露光後に加熱処理されるが、普通、その加熱温 度が変化するとレジストパターンの線幅もある程度変動 するのが避けられない。しかし、近年における集積回路 素子の微細化を反映して、露光後の加熱温度の変化に対 しても線幅の変動(即ち温度依存性)が小さいレジスト の開発も強く求められるようになってきた。

【0005】さらに、化学増幅型感放射線性組成物のレ ジストとしての特性を改良する方策の一つとして、高分 子あるいは低分子の添加剤を配合した3成分以上の多成 分系組成物が多数提案されており、例えば特開平7-2 34511号公報には、親水性基を有する樹脂として、 p-ヒドロキシスチレンと (メタ) アクリル酸テトラヒ ドロピラニルや (メタ) アクリル酸 t ープチルとの共重 合体、p-ヒドロキシスチレンとp-テトラヒドロピラ ニルオキシカルボニルオキシスチレンやp-t-プトキ シカルボニルオキシスチレンとの共重合体等のp-ヒド ロキシスチレン共重合体を含有するレジストに、疎水性 化合物として3-アダマンタンカルボン酸 t-ブチルを 引き置き時間による影響が少なくなり、あるいは疎水性 の強い基を含むレジストの場合にも安定したパターニン グが可能となることが開示されている。しかしながら、 特開平7-234511号公報のものを含む従来の多成 分系化学増幅型感放射線性組成物では、特に、ライン・ アンド・スペースパターンの疎密度によるラインパター ンの線幅の変動が大きく、レジストとしての性能面で未 だ満足できない。このような状況の下、集積回路素子に おける微細化の進行と利用分野の拡大に対応しうる技術 開発の観点から、遠紫外線に代表される短波長の放射線 に適応可能で、特に、ライン・アンド・スペースパター ンの疎密度によるラインパターンの線幅の変動が小さ く、かつ放射線に対する透明性、感度、解像度等にも優 れた新たな化学増幅型レジストの開発が強く求められて いる。

[0006]

50

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、特 に、ライン・アンド・スペースパターンのスペース幅が 広い場合にも、微細なラインパターンを形成でき、しか も放射線に対する透明性、感度、解像度等にも優れた化

学増幅型レジストとして有用な感放射線性樹脂組成物を 提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明によると、前記課題は、(A)下記一般式(1)に示す繰り返し単位(I-1)、繰返し単位(I-2)および繰返し単位(I-3)の群から選ばれる少なくとも1種の繰返し単位と、下記一般式(2)に示す繰返し単位(II)とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶性を示すアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、(B)感放射線性酸発生剤、並びに(C)式-COOR*〔式中、R*は水素原

子、置換もしくは非置換の炭素数 1~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、置換もしくは非置換の炭素数 3~20の1価の脂環式炭化水素基または-CH, COOR' (但し、R' は水素原子、置換もしくは非置換の炭素数 1~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または置換もしくは非置換の炭素数 3~20の1価の脂環式炭化水素基である。)を示す。〕で表される基を有する分子量1,000以下の多環式化合物を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物

10 [0008]

【化3】

〔一般式(1)において、 R^1 、 R^3 および R^6 は相互に独立に水素原子またはメチル基を示し、 R^1 、 R^4 および R^6 は相互に独立に水素原子または炭素数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、X はメチレン基、酸素原子または硫黄原子を示し、a は $1\sim5$ の整数である。〕

[0009]

【化4】

$$\begin{array}{c|c}
 & R^7 \\
\hline
 & C \\
 & R^8 \\
 & C \\
 & R^8
\end{array}$$
(11)

【0010】(一般式(2)において、R'は水素原子 40 またはメチル基を示し、各R[®] は相互に独立に炭素数 4 ~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、または炭素数 1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、且つR[®] の少なくとも1つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2つのR[®] が相互の結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数 4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成して、残りのR[®] が炭素数 1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数 4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体で50

ある。〕によって達成される。

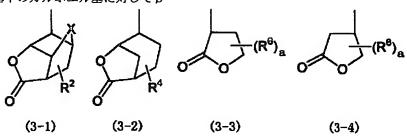
【0011】以下、本発明について詳細に説明する。 樹脂(A)

本発明における(A)成分は、前記一般式(1)に示す繰り返し単位(I-1)、繰返し単位(I-2)および繰返し単位(I-3)の群から選ばれる少なくとも1種の繰返し単位と、前記一般式(2)に示す繰返し単位

(11)とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶性を示すアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂(以下、「樹脂(A)」という。)からなる。ここでいう「アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性」とは、樹脂(A)を含有する感放射線性樹脂組成物から形成されたレジスト被膜からレジストパターンを形成する際に採用されるアルカリ現像条件下で、当該レジスト被膜の代わりに樹脂(A)のみを用いた被膜を現像した場合に、当該被膜の初期膜厚の50%以上が現像後に残存する性質を意味する。

【0012】繰返し単位(I-1)および繰返し単位(I-2)において、各繰返し単位の主鎖炭素原子に結合しているカルボニルオキシ基は、環中のラクトン基を形成している炭素原子および基R'あるいは基R'が結合している炭素原子以外の任意の炭素原子の位置で結合することができるが、好ましい結合位置は、それぞれ下記式(3-1)あるいは下記式(3-2)に示す位置である。

置で結合することができるが、好ましい結合位置は、下 記式(3-3)に示す位置(即ち、ラクトン基中のカル ポニル基に対して α - 位) または式(3-4) に示す位 置(即ち、ラクトン基中のカルボニル基に対してβ位) である。 [0014] 【化5】



【0015】また、繰返し単位 (I-1)、繰返し単位 (I-2) および繰返し単位 (I-3) において、基R ¹、基R¹および基R¹は、各繰返し単位中のカルボニ ルオキシ基が結合している炭素原子およびラクトン基を 形成している炭素原子以外の任意の炭素原子の位置で結 合することができる。R'、R'およびR'の炭素数1 ~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例 えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロ 20 ピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メ チルプロピル基、 t - ブチル基等を挙げることができ る。これらのアルキル基のうち、メチル基が好ましい。 また、繰返し単位 (I-3) におけるaとしては、1ま たは2が好ましい。

【0016】好ましい繰返し単位(I-1)としては、 例えば、R'が水素原子であり、主鎖炭素原子に結合し ているカルボニルオキシ基が前記式(3-1)に示す位 置に結合しており、R¹ が水素原子であるアクリル系繰 返し単位; R¹ が水素原子であり、主鎖炭素原子に結合 しているカルボニルオキシ基が前記式(3-1)に示す 位置に結合しており、R'がメチル基であるメタクリル 系繰返し単位; R' がメチル基であり、主鎖炭素原子に 結合しているカルボニルオキシ基が前記式(3-1)に 示す位置に結合しており、R' が水素原子であるアクリ ル系繰返し単位;R¹ がメチル基であり、主鎖炭素原子 に結合しているカルボニルオキシ基が前記式(3-1) に示す位置に結合しており、R' がメチル基であるメタ クリル系繰返し単位等を挙げることができる。

【0017】また、好ましい繰返し単位(I-2)とし 40 ては、例えば、R⁴ が水素原子であり、主鎖炭素原子に 結合しているカルポニルオキシ基が前記式 (3-2) に 示す位置に結合しており、R3 が水素原子であるアクリ ル系繰返し単位; R'が水素原子であり、主鎖炭素原子 に結合しているカルポニルオキシ基が前記式 (3-2) に示す位置に結合しており、R'がメチル基であるメタ クリル系繰返し単位; R' がメチル基であり、主鎖炭素 原子に結合しているカルポニルオキシ基が前記式 (3-2) に示す位置に結合しており、R'が水素原子である

素原子に結合しているカルボニルオキシ基が前記式(3 -2) に示す位置に結合しており、R³ がメチル基であ るメタクリル系繰返し単位等を挙げることができる。

8

【0018】また、好ましい繰返し単位(I-3)とし ては、例えば、R⁶ が水素原子であり、主鎖炭素原子に 結合しているカルボニルオキシ基が前記式 (3-3) ま たは式(3-4)に示す位置に結合しており、R⁶が水 素原子であるアクリル系繰返し単位; R' が水素原子で あり、主鎖炭素原子に結合しているカルボニルオキシ基 が前記式 (3-3) または式 (3-4) に示す位置に結 合しており、R⁶ がメチル基であるメタクリル系繰返し 単位; R⁶ がメチル基であり、主鎖炭素原子に結合して いるカルボニルオキシ基が前記式(3-3)または式 (3-4) に示す位置に結合しており、R'が水素原子 であるアクリル系繰返し単位;R'がメチル基であり、 主鎖炭素原子に結合しているカルボニルオキシ基が前記 式(3-3)または式(3-4)に示す位置に結合して おり、R¹ がメチル基であるメタクリル系繰返し単位等 を挙げることができる。

【0019】本発明において、繰返し単位(I-1)、 繰返し単位 (I-2) および繰返し単位 (I-3) のう ち、繰返し単位(I-1) および繰返し単位 (I-2) が好ましく、特に好ましくは繰返し単位 (I-1) であ る。樹脂(A)において、繰返し単位(I-1)、繰返 し単位 (I-2) および繰返し単位 (I-3) は、それ ぞれ単独でまたは2種以上が存在することができる。繰 返し単位(I-1)、繰返し単位(I-2)および繰返 し単位(I-3)は、それぞれ対応する(メタ)アクリ ル酸エステルに由来する繰返し単位である。

【0020】次に、繰返し単位 (II) において、R[®] の 炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基、および何れ か2つのR®が相互に結合して形成した炭素数4~20 の2価の脂環式炭化水素基としては、例えば、ノルボル ナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダ マンタンや、シクロプタン、シクロペンタン、シクロヘ キサン、シクロヘプタン、シクロオクタン等のシクロア ルカン類等に由来する脂環族環からなる基;これらの脂 アクリル系繰返し単位; R' がメチル基であり、主鎖炭 50 環族環からなる基を、例えば、メチル基、エチル基、n

-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等の炭素数1~4の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等を挙げることができる。これらの1価または2価の脂環式炭化水素基のうち、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンまたはアダマンタンに由来する脂環族環からなる基や、これらの脂環族環からなる基を前記アルキル基で置換した基等が好ましい。

【0021】また、前記1価または2価の脂環式炭化水 10 素基の誘導体としては、例えば、ヒドロキシル基:カル ボキシル基:オキソ基(即ち、=〇基):ヒドロキシメ チル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチ ル基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロ ピル基、3-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシブ チル基、2-ヒドロキシプチル基、3-ヒドロキシプチ ル基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒド ロキシアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、n-プロ ポキシ基、i-プロポキシ基、n-プトキシ基、2-メ チルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ基、t-ブト 20 キシ基等の炭素数1~4のアルコキシル基;シアノ基; シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロ ピル基、4-シアノブチル基等の炭素数2~5のシアノ アルキル基等の置換基を1種以上あるいは1個以上有す る基を挙げることができる。これらの置換基のうち、ヒ ドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシメチル基、 シアノ基、シアノメチル基等が好ましい。

【0022】また、R⁵の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等を挙げることができる。これらのアルキル基のうち、特に、メチル基、エチル基等が好ましい。 【0023】繰返し単位(II)における基-COOC

 (R°) 、は、酸の作用により解離してカルボキシル基を形成する酸解離性基をなしている。以下では、この基を酸解離性基(i)という。好ましい酸解離性基(i)の具体例としては、 $t-プトキシカルボニル基や、下記式<math>(i-1)\sim(i-49)$ の基等を挙げることができる。

[0024]

【化6】

[0025] [化7]

(i-4) (i-5)

[0026] 【化8】

50 [0027]

40

13 14 ·CH₃ CH₃ -CH₃ (i-30) (i-28) (i-29) (i-34)(i-35) (i-36)[0034] [0036] 【化16】 【化18】 C₂H₅ C₂H₅ C₂H₅ (i-31)(i-32) (i-33) (i-37) (i-38)(i-39) [0035] [0037] 【化17】 【化19】 (i-40)(i-41)(i-42) [0038] 【化20】 (i-43) (i-44) (i-45)[0039] 【化21】 (i-46) (i-48)(i-49)(i-47)

【0040】これらの酸解離性基(i)のうち、t-プ (i-10)、式(i-11)、式(i-13)、式(i-14)、式 トキシカルポニル基や、式(i-1)、式(i-2)、式 50 (i-16)、式(i-17)、式(i-34)、式(i-35)、式

(i-40)、式(i-41)、式(i-48)または式(i-49)の基等が好ましい。樹脂(A)において、繰返し単位(II)は、単独でまたは2種以上が存在することができる。繰返し単位(II)は、対応する(メタ)アクリル酸エステルに由来する繰返し単位である。

【0041】樹脂(A)は、繰返し単位(I-1)、繰返し単位(I-2)、繰返し単位(I-3)および繰返し単位(II)以外の繰返し単位(以下、「他の繰返し単位」という。)を1種以上有することができる。他の繰返し単位を与える重合性不飽和単量体としては、例えば、(メタ)アクリル酸ノルボルニル、(メタ)アクリル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸テトラシクロデカニル、(メタ)アクリル酸デーシンのロデカニル、(メタ)アクリル酸ジシクロペンテニル、(メタ)アクリル酸アダマンチル、(メタ)アクリル酸アダマンチル、(メタ)アクリル酸アダマンチル、(メタ)アクリル酸アダマンチル、(メタ)アクリル酸カルボキシノルボルニル、(メタ)アクリル酸カルボキシノルボルニル、(メタ)アクリル酸カルボキシトリシクロデカニル、(メタ)アクリル酸カルボキシトリシクロデカニル、

(メタ)アクリル酸カルボキシテトラシクロデカニル等 20 の不飽和カルボン酸の有橋式炭化水素骨格を有するカルボキシル基含有エステル類;

【0042】ノルボルネン(即ち、ビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-エン)、5-メチルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーエチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプト-2-エン、5-n-プロピルビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-エン、5-n-ブチルビシ クロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-n-ペンチ ルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-n-ヘキシルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5 30 ーヒドロキシビシクロ[2.2.1]ヘプトー2ーエ ン、5-ヒドロキシメチルビシクロ[2.2.1]ヘプ トー2-エン、テトラシクロ[4.4.0.11.1.1 「· · · ·]ドデカー3ーエン、8-メチルテトラシクロ -エチルテトラシクロ [4. 4. 0. 1^{3.6} . 1^{7.10}] ドデカー3-エン、8-n-プロピルテトラシクロ [4.4.0.11.6.17.10]ドデカー3ーエン、8 -n-プチルテトラシクロ[4.4.0.1^{1.1}.1 7.10]ドデカー3ーエン、8-n-ペンチルテトラシク 40 ロ [4.4.0.12.5]ドデカー3ーエン、 8-n-ヘキシルテトラシクロ [4.4.0.11.6. 17.10]ドデカー3ーエン、8ーヒドロキシテトラシク ロ[4.4.0.12.6.17.10]ドデカー3ーエン、 8ーヒドロキシメチルテトラシクロ[4.4.0.1 ^{1.1} . 1^{7.10}]ドデカー3-エン、

【0043】8-フルオロテトラシクロ[4.4.0.1'.'.']ドデカ-3-エン、8-フルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1'.'.1''!]ドデカ-3-エン、8-ジフルオロメチルテトラシクロ[4.

4. 0. 11.5 . 17.10]ドデカー3ーエン、8ートリ フルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.11.5.1 **゙・・゚**]ドデカー3ーエン、8-ペンタフルオロエチルテ トラシクロ[4. 4. 0. 11.6 . 17.10]ドデカー3 -エン、8,8-ジフルオロテトラシクロ[4.4. 0.11.6.17.10]ドデカー3ーエン、8,9ージフ ルオロテトラシクロ[4. 4. 0. 1*.* . 1'.10]ド デカー3ーエン、8,8ービス(トリフルオロメチル) テトラシクロ[4. 4. 0. 11.5 . 17.10]ドデカー 3-エン、8, 9-ビス (トリフルオロメチル) テトラ シクロ[4. 4. 0. 13.5 . 17.10]ドデカー3ーエ ン、8-メチル-8-トリフルオロメチルテトラシクロ [4. 4. 0. 11.6 . 17.10]ドデカー3ーエン、 【0044】8,8,9-トリフルオロテトラシクロ[4. 4. 0. 1^{1.5} . 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8, 8, 9-トリス (トリフルオロメチル) テトラシクロ[4. 4. 0. 1^{1.5}. 1^{7.10}]ドデカー3-エン、8、 8, 9, 9ーテトラフルオロテトラシクロ[4.4.4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ーエン、8, 8, 9, 9-テトラキス (トリフルオロメチル) テトラシクロ[4. 4. 0. 1^{1.5} . 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8. 8-ジフルオロー9,9-ビス(トリフルオロメチル) テトラシクロ[4. 4. 0. 11.1 . 17.10]ドデカー 3-エン、8,9-ジフルオロ-8,9-ビス(トリフ ルオロメチル) テトラシクロ[4.4.0.11.1.1 ^{7.10}]ドデカー3ーエン、8,8,9-トリフルオロー 9-トリフルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1 *· ' . 1'· ']ドデカー3-エン、8, 8, 9-トリフ ルオロー9-トリフルオロメトキシテトラシクロ[4. 4. 0. 11.5 . 17.10]ドデカー3ーエン、 【0045】8,8,9-トリフルオロ-9-ペンタフ ルオロプロポキシテトラシクロ[4.4.0.11.6. 1'・10]ドデカー3ーエン、8-フルオロー8ーペンタ フルオロエチルー9,9-ビス(トリフルオロメチル) 3-エン、8,9-ジフルオロ-8-ヘプタフルオロイ ソプロピルー9-トリフルオロメチルテトラシクロ[4. 4. 0. 11.6 . 17.10]ドデカー3ーエン、8-クロロー8, 9, 9ートリフルオロテトラシクロ[4. 4. 0. 13.6 . 17.10]ドデカー3ーエン、8. 9ー ジクロロー8,9-ピス(トリフルオロメチル)テトラ シクロ[4. 4. 0. 13.6 . 17.10]ドデカー3ーエ ン、8-(2', 2', 2'-トリフルオロカルポエト キシ) テトラシクロ[4. 4. 0. 12.5 . 17.10]ド デカー3ーエン、8ーメチルー8ー(2', 2', 2' - トリフルオロカルポエトキシ)テトラシクロ[4. 4. 0. 12.5 . 17.10]ドデカー3ーエン、 【0046】ジシクロペンタジエン、トリシクロ[5. 2. 1. 01.6] デカー8ーエン、トリシクロ[5.

2. 1. 0^{1.6}] デカー3-エン、トリシクロ[4.

4. 0. 1^{1.6}] ウンデカー3-エン、トリシクロ[6. 2. 1. 0^{1.8}] ウンデカー9-エン、トリシクロ [6.2.1.01.8] ウンデカー4ーエン、テトラシ クロ[4.4.0.11.6.17.10.01.6]ドデカー 3-エン、8-メチルテトラシクロ[4.4.0.1 *.5 . 1^{7.10} . 0^{1.6}] ドデカー3ーエン、8ーエチリ デンテトラシクロ[4.4.0.11.1.1.1]ドデ カー3-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4.4. 0.11.6.17.10.01.6] ドデカー3ーエン、ペン タシクロ[6.5.1.13.6.02.7.09.13]ペン 10 タデカー4ーエン、ペンタシクロ[7.4.0.1 *.・ . 1*.12. 0*.13]ペンタデカー3-エン等の有橋 式炭化水素骨格を有する他の単官能性単量体;

【0047】 (メタ) アクリル酸メチル、 (メタ) アク リル酸エチル、(メタ)アクリル酸 n-プロピル、(メ タ) アクリル酸 n - プチル、(メタ) アクリル酸 2 - メ チルプロピル、(メタ) アクリル酸2-ヒドロキシエチ ル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、(メ タ) アクリル酸3-ヒドロキシプロピル、(メタ) アク リル酸シクロプロピル、(メタ)アクリル酸シクロペン 20 チル、(メタ) アクリル酸シクロヘキシル、(メタ) ア クリル酸4-メトキシシクロヘキシル、(メタ)アクリ ル酸2-シクロペンチルオキシカルボニルエチル、(メ タ) アクリル酸2-シクロヘキシルオキシカルボニルエ チル、(メタ) アクリル酸2-(4-メトキシシクロへ キシル) オキシカルボニルエチル等の有橋式炭化水素骨 格をもたない(メタ)アクリル酸エステル類:

【0048】 αーヒドロキシメチルアクリル酸メチル、 α ーヒドロキシメチルアクリル酸エチル、 α ーヒドロキ シメチルアクリル酸 n - プロピル、α-ヒドロキシメチ 30 ルアクリル酸nープチル等のαーヒドロキシメチルアク リル酸エステル類; (メタ) アクリロニトリル、 α - α ロロアクリロニトリル、クロトンニトリル、マレインニ トリル、フマロニトリル、メサコンニトリル、シトラコ ンニトリル、イタコンニトリル等の不飽和ニトリル化合 物; (メタ) アクリルアミド、N, N-ジメチル (メ 夕) アクリルアミド、クロトンアミド、マレインアミ ド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミ ド、イタコンアミド等の不飽和アミド化合物; N- (メ タ) アクリロイルモルホリン、N-ビニル-ε-カプロ 40 ラクタム、Nービニルピロリドン、ビニルピリジン、ビ ニルイミダゾール等の他の含窒素ピニル化合物; (メ タ) アクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、無水マレイ ン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸、シトラ コン酸、無水シトラコン酸、メサコン酸等の不飽和カル ボン酸(無水物)類; (メタ) アクリル酸 2 - カルポキ シエチル、(メタ) アクリル酸2-カルボキシプロピ ル、(メタ)アクリル酸3-カルポキシプロピル、(メ タ) アクリル酸 4 - カルポキシプチル、(メタ) アクリ ル酸 4 - カルポキシシクロヘキシル等の不飽和カルポン 50 - (メタ) アクリロイルオキシ-γ-プチロラクトン、

酸の有橋式炭化水素骨格をもたないカルボキシル基含有 エステル類:

 $[0049]\alpha-(メタ)アクリロイルオキシ-β-メ$ トキシカルボニルーγ-プチロラクトン、α- (メタ) アクリロイルオキシーβ-エトキシカルボニル-γ-ブ チロラクトン、αー (メタ) アクリロイルオキシーβー $n-\mathcal{I}$ ロポキシカルボニルー $\gamma-\mathcal{I}$ チロラクトン、 $\alpha-$ (メタ) アクリロイルオキシーβ-i-プロポキシカル ボニルーγープチロラクトン、αー(メタ)アクリロイ ルオキシーβ-n-プトキシカルボニル-γ-プチロラ クトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -(2-メチルプロポキシ) カルボニル-ィープチロラクトン、 ロポキシ) カルボニルーγープチロラクトン、αー(メ タ) アクリロイルオキシーβ-t-プトキシカルボニル $-\gamma$ - \vec{J} + \vec{U} + \vec{U} - \vec{U} + \vec{U} - $\vec{U$ シーβ-シクロヘキシルオキシカルボニル-γ-ブチロ ラクトン、 α - (メタ) アクリロイルオキシ-8 - (4 - t - プチルシクロヘキシルオキシ) カルボニル- r -プチロラクトン、α-(メタ) アクリロイルオキシ-β -フェノキシカルボニル-γ-ブチロラクトン、α-(メタ) アクリロイルオキシーβ-(1-エトキシエト キシ) カルボニルー γ ーブチロラクトン、 α - (メタ) アクリロイルオキシーβ-(1-シクロヘキシルオキシ エトキシ) カルボニルーγープチロラクトン、αー (メ タ) アクリロイルオキシーβ-t-プトキシカルボニル メトキシカルボニルーγープチロラクトン、α- (メ タ) アクリロイルオキシーβ-テトラヒドロフラニルオ キシカルポニルー γ ープチロラクトン、 α - (メタ) ア クリロイルオキシーβーテトラヒドロピラニルオキシカ ルボニルーィープチロラクトン、

[0050] $\alpha-$ メトキシカルポニル $-\beta-$ (メタ) ア クリロイルオキシーγープチロラクトン、αーエトキシ カルポニルーβー (メタ) アクリロイルオキシーィーブ チロラクトン、α-n-プロポキシカルボニル-β-(メタ) アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン、α - i - プロポキシカルボニル-β- (メタ) アクリロイ ルオキシー γ ープチロラクトン、α – n – プトキシカル ポニルーβー (メタ) アクリロイルオキシーγープチロ ラクトン、α-(2-メチルプロポキシ) カルボニルβ- (メタ) アクリロイルオキシ-γ-ブチロラクト ン、α-(1-メチルプロポキシ)カルボニル-β-(メタ) アクリロイルオキシー γ - プチロラクトン、α - t - プトキシカルポニル - β - (メタ) アクリロイル オキシーγープチロラクトン、α-シクロヘキシルオキ シカルボニルーβー(メタ)アクリロイルオキシーγー プチロラクトン、α-(4-t-プチルシクロヘキシル オキシ) カルボニル-β-(メタ) アクリロイルオキシ $-\gamma - \mathcal{I}\mathcal{F}$ ロラクトン、 $\alpha - \mathcal{I}$ ェノキシカルポニル $-\beta$

 $\alpha - (1 - x + y + y + y)$ タ) アクリロイルオキシ-γ-プチロラクトン、α-(1-シクロヘキシルオキシエトキシ) カルボニル-B - (メタ) アクリロイルオキシーγープチロラクトン、 α-t-プトキシカルボニルメトキシカルボニル-β-(メタ) アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン、α ーテトラヒドロフラニルオキシカルポニルーβー (メ タ)アクリロイルオキシーγープチロラクトン、αーテ トラヒドロピラニルオキシカルボニル-β-(メタ)ア クリロイルオキシーィープチロラクトン等の酸解離性基 10 を有する(メタ)アクリロイルオキシラクトン化合物; $[0051]\alpha-(y9)$ アクリロイルオキシーβ-フ ルオローγープチロラクトン、αー(メタ) アクリロイ ルオキシーβーヒドロキシーγープチロラクトン、αー (メタ) アクリロイルオキシーβ-メチル-γ-プチロ ラクトン、α- (メタ) アクリロイルオキシ-β-エチ キシー β , β -ジメチルー γ -プチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシーβ-メトキシーγ-プチ

19

オキシーγープチロラクトン、αーヒドロキシーβー (メタ) アクリロイルオキシー γ – プチロラクトン、α メチルーβー(メタ)アクリロイルオキシーγープチ ロラクトン、α-エチル-β-(メタ) アクリロイルオ (メタ) アクリロイルオキシー γ - プチロラクトン、α **ーメトキシーβー(メタ)アクリロイルオキシーγーブ**

ロラクトン、 α - フルオロ - β - (メタ) アクリロイル 20

チロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- δ -メバロノラクトン等の酸解離性基をもたない(メタ)ア クリロイルオキシラクトン化合物;前記不飽和カルボン 30 酸類あるいは前記不飽和カルボン酸の有橋式炭化水素骨 格をもたないカルボキシル基含有エステル類のカルボキ シル基を、下記する酸解離性基(i)に変換した化合物 等の単官能性単量体や、

【0052】1、2-アダマンタンジオールジ(メタ) アクリレート、1,3-アダマンタンジオールジ(メ タ) アクリレート、1、4-アダマンタンジオールジ (メタ) アクリレート、トリシクロデカニルジメチロー ルジ(メタ)アクリレート等の有橋式炭化水素骨格を有 する多官能性単量体;

【0053】メチレングリコールジ(メタ)アクリレー ト、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロ ピレングリコールジ (メタ) アクリレート、1、6-ヘ キサンジオールジ (メタ) アクリレート、2, 5-ジメ チルー2,5-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレー ト、1、8-オクタンジオールジ(メタ)アクリレー ト、1、9-ノナンジオールジ(メタ)アクリレート、 1,4-ピス(2-ヒドロキシプロピル)ベンゼンジ (メタ) アクリレート、1、3-ビス(2-ヒドロキシ

炭化水素骨格をもたない多官能性単量体等の多官能性単 量体を挙げることができる。

【0054】樹脂 (A) において、繰返し単位 (I-1) 、繰返し単位 (I-2) および繰返し単位 (I-3) の合計含有率は、全繰返し単位に対して、通常、1 0~80モル%、好ましくは20~70モル%、さらに 好ましくは30~70モル%である。この場合、前記合 計含有率が10モル%未満では、レジストとしたときの 現像性や基板への接着性が低下する傾向があり、一方8 0モル%を超えると、レジストとしての解像度が低下す る傾向がある。また、繰返し単位(II)の含有率は、全 繰返し単位に対して、通常、10~80モル%、好まし くは20~70モル%、さらに好ましくは20~60モ ル%である。この場合、繰返し単位(11)の含有率が1 0モル%未満では、レジストとしての解像度が低下する 傾向があり、一方80モル%を超えると、レジストとし たとき現像性が低下したり、スカムが発生しやすくなる 傾向がある。また、他の繰返し単位の含有率は、全繰返 し単位に対して、通常、50モル%以下、好ましくは4 0モル%以下である。

【0055】樹脂(A)は、例えば、その各繰返し単位 に対応する重合性不飽和単量体を、ヒドロパーオキシド 類、ジアルキルパーオキシド類、ジアシルパーオキシド 類、アゾ化合物等のラジカル重合開始剤を使用し、必要 に応じて連鎖移動剤の存在下、適当な溶媒中で重合する ことにより製造することができる。前記重合に使用され る溶媒としては、例えば、n-ペンタン、n-ヘキサ ン、n-ヘプタン、n-オクタン、n-ノナン、n-デ カン等のアルカン類;シクロヘキサン、シクロヘプタ ン、シクロオクタン、デカリン、ノルボルナン等のシク ロアルカン類;ペンゼン、トルエン、キシレン、エチル ペンゼン、クメン等の芳香族炭化水素類;クロロプタン 類、プロモヘキサン類、ジクロロエタン類、ヘキサメチ レンジプロミド、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水 素類;酢酸エチル、酢酸 n - ブチル、酢酸 i - ブチル、 プロピオン酸メチル等の飽和カルボン酸エステル類:メ チルエチルケトン、メチルイソプチルケトン、2-ヘプ タノン等のケトン類;テトラヒドロフラン、ジメトキシ エタン類、ジエトキシエタン類等のエーエル類等を挙げ 40 ることができる。これらの溶媒は、単独でまたは2種以 上を混合して使用することができる。また、前記重合に おける反応温度は、通常、40~120℃、好ましくは 50~90℃であり、反応時間は、通常、1~48時 間、好ましくは1~24時間である。

【0056】樹脂(A)のゲルパーミエーションクロマ トグラフィ(GPC)によるポリスチレン換算重量平均 分子量(以下、「Mw」という。)は、通常、3,00 $0 \sim 30$, 000、好ましくは5, $000 \sim 30$, 000、さらに好ましくは5,000~20,000であ プロピル) ペンゼンジ (メタ) アクリレート等の有橋式 50 る。この場合、樹脂 (A) のMwが3, 000未満で

は、レジストとしたときの耐熱性が低下する傾向があり、一方30,000を超えると、レジストとしたときの現像性が低下する傾向がある。また、樹脂(A)のMwとゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC)によるポリスチレン換算数平均分子量(以下、「Mn」という。)との比(Mw/Mn)は、通常、1~5、好ましくは1~3である。なお、樹脂(A)は、ハロゲン、金属等の不純物が少ないほど好ましく、それにより、レジストとしたときの感度、解像度、プロセス安定性、パターン形状等をさらに改善することができる。樹10脂(A)の精製法としては、例えば、水洗、液々抽出等の化学的精製法や、これらの化学的精製法と限外ろ過、遠心分離等の物理的精製法との組み合わせ等を挙げることができる。

【0057】酸発生剤(B)

本発明における(B)成分は、露光により酸を発生する 感放射線性酸発生剤化合物(以下、「酸発生剤(B)」 という。)からなる。酸発生剤(B)としては、例え ば、オニウム塩化合物、ハロゲン含有化合物、ジアゾケ トン化合物、スルホン化合物、スルホン酸化合物等を挙 20 げることができる。以下に、これらの酸発生剤(B)の 例を挙げる。

オニウム塩化合物:オニウム塩化合物としては、例え ば、ヨードニウム塩、スルホニウム塩(チオフェニウム 塩を含む。)、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、ピリ ジニウム塩等を挙げることができる。好ましいオニウム 塩化合物としては、例えば、ジフェニルヨードニウムト リフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウ ムノナフルオローnープタンスルホネート、ジフェニル ヨードニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネー ト、ビス(4 - t - プチルフェニル)ヨードニウムトリ フルオロメタンスルホネート、ビス(4-t-プチルフ ェニル) ヨードニウムノナフルオローnープタンスルホ ネート、ピス (4-t-プチルフェニル) ヨードニウム パーフルオローnーオクタンスルホネート、トリフェニ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリ フェニルスルホニウムノナフルオローnープタンスルホ ネート、トリフェニルスルホニウムパーフルオローnー オクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム 1 0-カンファースルホネート、シクロヘキシル・2-オ 40 キソシクロヘキシル・メチルスルホニウムトリフルオロ メタンスルホネート、ジシクロヘキシル・2-オキソシ クロヘキシルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネ ート、2-オキソシクロヘキシルジメチルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート、1-(3,5-ジメ チルー4-ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェ ニウムノナフルオロ-n-プタンスルホネート、1-(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) テトラ ヒドロチオフェニウムパーフルオローnーオクタンスル

フェニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、4ーメチルフェニルー1ーテトラヒドロチオフェニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、4ーヒドロキシー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、4ーヒドロキシー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、4ーnーブトキシー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、4ーnーブトキシー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオローnーオクタンスルホネート、1ー(1ーナフチルアセトメチル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、1ー(1ーナフチルアセトメチル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、1ー(1ーナフチルアセトメチル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー10分ンスルホネート、110分別できる。

【0058】ハロゲン含有化合物:ハロゲン含有化合物 としては、例えば、ハロアルキル基含有炭化水素化合 物、ハロアルキル基含有複素環式化合物等を挙げること ができる。好ましいハロゲン含有化合物としては、例え ば、フェニルビス (トリクロロメチル) - s - トリアジ ン、4-メトキシフェニルビス(トリクロロメチル)s-トリアジン、1-ナフチルビス(トリクロロメチ ル) - s - トリアジン等の(トリクロロメチル) - s -トリアジン誘導体や、1,1-ビス(4-クロロフェニ ル)-2,2,2-トリクロロエタン等を挙げることが できる。ジアゾケトン化合物:ジアゾケトン化合物とし ては、例えば、1、3-ジケト-2-ジアゾ化合物、ジ アゾベンゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等 を挙げることができる。好ましいジアゾケトンとして は、例えば、1,2-ナフトキノンジアジド-4-スル ホニルクロリド、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロリド、2,3,4,4'-テトラヒドロ キシベンゾフェノンの1,2-ナフトキノンジアジドー 4-スルホン酸エステルまたは1,2-ナフトキノンジ アジド-5-スルホン酸エステル、1,1,1-トリス (4-ヒドロキシフェニル) エタンの1, 2-ナフトキ ノンジアジドー4-スルホン酸エステルまたは1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル等を挙 げることができる。

【0059】スルホン化合物:スルホン化合物としては、例えば、 β -ケトスルホン、 β -スルホニルスルホンや、これらの化合物の α -ジアゾ化合物等を挙げることができる。好ましいスルホン化合物としては、例えば、4-トリスフェナシルスルホン、メシチルフェナシルスルホン、ビス(フェニルスルホニル)メタン等を挙げることができる。

ニウムノナフルオローn ープタンスルホネート、1 ー スルホン酸化合物:スルホン酸化合物としては、例え (3,5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)テトラ ば、アルキルスルホン酸エステル、アルキルスルホン酸 ヒドロチオフェニウムパーフルオローnーオクタンスル イミド、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールスホネート、4-メチルフェニルー1-テトラヒドロチオ 50 ルホン酸エステル、イミノスルホネート等を挙げること

ができる。好ましいスルホン酸化合物としては、例え ば、ペンゾイントシレート、ピロガロールのトリス(ト リフルオロメタンスルホネート)、ニトロペンジルー 9,10-ジエトキシアントラセン-2-スルホネー ト、トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2. 1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、ノ ナフルオローnープタンスルホニルビシクロ[2.2. 1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボジイミド、パ ーフルオロ-n-オクタンスルホニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミ ド、N-ヒドロキシスクシイミドトリフルオロメタンス ルホネート、N-ヒドロキシスクシイミドノナフルオロ -n-プタンスルホネート、N-ヒドロキシスクシイミ ドパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1,8-ナフタレンジカルボン酸イミドトリフルオロメタンスル ホネート、1,8-ナフタレンジカルボン酸イミドノナ フルオローnープタンスルホネート、1、8-ナフタレ ンジカルボン酸イミドパーフルオローn-オクタンスル ホネート等を挙げることができる。

【0060】これらの酸発生剤(B)のうち、ジフェニ 20 ルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフ ェニルヨードニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネ ート、ジフェニルヨードニウムパーフルオローn-オク タンスルホネート、ビス (4-t-プチルフェニル) ヨ ードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ピス (4 - t - プチルフェニル) ヨードニウムノナフルオロ-n ープタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニ ル) ヨードニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネ ート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロー 30 n-プタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムパ ーフルオローnーオクタンスルホネート、シクロヘキシ ル・2-オキソシクロヘキシル・メチルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート、ジシクロヘキシル・2 オキソシクロヘキシルスルホニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、2-オキソシクロヘキシルジメチルス ルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-n-プトキシー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムノ ナフルオローnープタンスルホネート、4-n-プトキ シー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフル 40 オローnーオクタンスルホネート、

【0061】トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイ ミド、ノナフルオローnープタンスルホニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイ ミド、パーフルオローnーオクタンスルホニルビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジ イミド、Nーヒドロキシスクシイミドトリフルオロメタ ンスルホネート、N-ヒドロキシスクシイミドノナフル

イミドパーフルオローn-オクタンスルホネート、1, 8-ナフタレンジカルポン酸イミドトリフルオロメタン スルホネート等が好ましい。前記酸発生剤(B)は、単 独でまたは2種以上を混合して使用することができる。 【0062】本発明における酸発生剤(B)の使用量 は、レジストとしての感度および現像性を確保する観点 から、樹脂(A)100重量部に対して、通常、0.1 ~20重量部、好ましくは0.5~10重量部である。 この場合、酸発生剤(B)の使用量が0.1重量部未満 10 では、感度および現像性が低下する傾向があり、一方2 0 重量部を超えると、放射線に対する透明性が低下し て、矩形のレジストパターンを得られ難くなる傾向があ る。

【0063】多環式化合物(C)

本発明における(C)成分は、式-COOR 〔式中、 R' は水素原子、置換もしくは非置換の炭素数1~20 の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、置換もしくは非 置換の炭素数3~20の1価の脂環式炭化水素基または -CH. COOR¹⁰ (但し、R¹⁰は水素原子、置換もし くは非置換の炭素数1~20の直鎖状もしくは分岐状の アルキル基または置換もしくは非置換の炭素数3~20 の1価の脂環式炭化水素基である。)を示す。〕で表さ れる基を有する分子量1,000以下の多環式化合物 (以下、「多環式化合物(C)」という。)からなる。 多環式化合物(C)において、式-COOR'で表され る基が複数存在するとき、各R' は相互に同一でも異な ってもよい。

【0064】多環式化合物(C)において、R°の置換 もしくは非置換の炭素数1~20のアルキル基として は、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i プロピル基、n-プチル基、2-メチルプロピル基、 1-メチルプロピル基、t-ブチル基、n-ペンチル 基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル 基、n-デシル基、n-ドデシル基、n-テトラデシル 基、n-ヘキサデシル基、n-オクタデシル基、n-エ イコシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シ クロオクチル基等の直鎖状、分岐状もしくは環状の非置 換アルキル基;これらの非置換アルキル基を、ヒドロキ シル基;カルポキシル基;オキソ基;ヒドロキシメチル 基、ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル基、 2-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロピル 基、1-ヒドロキシプチル基、2-ヒドロキシプチル 基、3-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシブチル基 等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基;メトキシ 基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ 基、n-プトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メ チルプロポキシ基、 t-プトキシ基等の炭素数 1~4の アルコキシル基:シアノメチル基、2-シアノエチル 基、3-シアノプロピル基、4-シアノブチル基等の炭 オローn-プタンスルホネート、N-ヒドロキシスクシ 50 素数2~5のシアノアルキル基等の置換基を1種以上あ

·

るいは1個以上有する基を挙げることができる。

25

【0065】また、Rºの置換もしくは非置換の炭素数 3~20の1価の脂環式炭化水素基としては、例えば、 ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカ ン、アダマンタンや、シクロプタン、シクロペンタン、 シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン等の シクロアルカン類等に由来する非置換の脂環族環からな る基;これらの非置換の脂環族環からなる基を、ヒドロ キシル基;カルポキシル基;オキソ基;ヒドロキシメチ ル基、ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル 基、2-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロピ ル基、1-ヒドロキシブチル基、2-ヒドロキシブチル 基、3-ヒドロキシプチル基、4-ヒドロキシプチル基 等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基:メトキシ 基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ 基、n-プトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メ チルプロポキシ基、 t - プトキシ基等の炭素数 1~4の アルコキシル基;シアノメチル基、2-シアノエチル 基、3-シアノプロピル基、4-シアノブチル基等の炭 素数2~5のシアノアルキル基等の置換基を1種以上あ 20 るいは1個以上有する基を挙げることができる。

【0066】また、 R^{10} の置換もしくは非置換の炭素数 $1\sim20$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基および置換もしくは非置換の炭素数 $3\sim20$ の 1 価の脂環式炭化水素基としては、例えば、前記 R^{0} について例示したそれぞれ対応する基を挙げることができる。

【0067】多環式化合物(C)におけるR°としては、水素原子、1ーメチルプロピル基、tープチル基、1ーメチルプロポキシカルボニルメチル基、tープトキシカルボニルメチル基等が好ましく、特に、tープチル 30基、tープトキシカルボニルメチル基等が好ましい。多環式化合物(C)において、R°が1ー分岐アルキル基もしくはその置換誘導体である場合、R°は酸の存在下で解離する。また、R°のーCH,COOR'。自体は酸の存在下で解離し、あるいはそのR'。が1ー分岐アルキル基もしくはその置換誘導体である場合はR'。も酸の存在下で解離する。これらの場合、多環式化合物(C)中

の-COOR' および-COO-CH, COOR''は酸解離性基をなしている。

【0068】多環式化合物(C)としては、例えば、下記一般式(4)で表される化合物(以下、「多環式化合物(C4)」という。)、下記一般式(5)で表される化合物(以下、「多環式化合物(C5)」という。)、下記一般式(6)で表される化合物(以下、「多環式化合物(C6)」という。)、下記一般式(7)で表される化合物(以下、「多環式化合物(C7)」という。)、下記一般式(8)で表される化合物(以下、

「多環式化合物 (C8)」という。)、下記一般式 (9)で表される化合物(以下、「多環式化合物(C 9)」という。)等を挙げることができる。

[0069]

【化22】

$$(COOR^{\theta})_2$$
 (4)

[0070]

【化23】

〔一般式 (5) において、2 は環構成炭素原子の合計数が $6\sim2$ 0 の多環式炭素環を有するm価の炭化水素基またはその誘導体を示し、mは $1\sim4$ の整数である。〕

[0071]

【化24】

[0072] [化25]

$$\mathbb{R}^{11} = \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}^{12}$$

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

「一般式 (7) において、R'' およびR'' は相互に独立 素数 $1 \sim 18$ のアパに水素原子、炭素数 $1 \sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のア ルキル基、炭素数 $1 \sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のヒド 炭素数 $1 \sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基また 以基である。 $1 \sim 18$ の企業である。 $1 \sim 18$ ので $1 \sim 18$ のアパロキシアルキル基、 $1 \sim 18$ ので $1 \sim 18$ のアパロキシアルキル基、 $1 \sim 18$ ので $1 \sim 18$ ので $1 \sim 18$ の $1 \sim 18$

素数 $1 \sim 18$ のアルキル基である。) $\}$ 、または-CO OR' $\{E$ $\{E$ $\{E\}$ $\{E\}$

[0073] [化26]

27

〔一般式(8)において、R''、R''、R''*およびR'' は相互に独立に水素原子、ヒドロキシル基、炭素数 $1 \sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数 $1 \sim 4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基を示す。〕

[0074] [化27]

[一般式 (9) において、R''、R''およびR''は相互に独立に水素原子またはヒドロキシル基を示し、かつR''、R''およびR''の少なくとも1つがヒドロキシル基である。]

【0075】環式化合物(C4)の具体例としては、

- 1, 2-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-プチル、
- 1,3-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-ブチル、
- 1, 4-アダマンタンジカルボン酸ジー t-プチル、
- 2, 2-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-ブチル、
- 2, 4-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-プチル、
- 2,9-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-プチル、

2, ョープラマンラフンカルホン酸シー t ープテル、
1, 2ーアダマンタンジカルボン酸ジー t ープトキシカルボニルメチル、1, 3ーアダマンタンジカルボン酸ジー t ープトキシカルボニルメチル、1, 4ーアダマンタ 30ンジカルボン酸ジー t ープトキシカルボニルメチル、2, 2ーアダマンタンジカルボン酸ジー t ープトキシカルボニルメチル、2, 4ーアダマンタンジカルボン酸ジー t ープトキシカルボニルメチル、2, 9ーアダマンタンジカルボン酸ジー t ープトキシカルボニルメチル、2, 9ーアダマンタンジカルボン酸ジー t ープトキシカルボニルメチル、

【0076】1-t-プトキシカルボニル-2-t-プトキシカルボニルメトキシカルボニルアダマンタン、1-t-プトキシカルボニルアダマンタン、1-t-プトキシカルボニルアダマンタン、<math>1-t-プトキシカルボニルアグマンタン、1-t-プトキシカルボニルアグマンタン、2-t-プトキシカルボニルアグマンタン、2-t-プトキシカルボニルアグマンタン、2-t-プトキシカルボニルアグマンタン、2-t-プトキシカルボニルアグマンタン、2-t-プトキシカルボニルアグマンタン、1-t-プトキシカルボニルアグマンタン、1-t-プトキシカルボニルアグマンタン、<math>1-t-プトキシカルボニルアグマンタン、1-t-プトキシカルボニルアグマンタン、1-t-プトキシカルボニルアグマンタン、1-t-プトキシカルボニルアグマンタン、50

【0077】これらの多環式化合物(C4)のうち、特に、1,3-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-プチル、1,3-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-プトキ20シカルボニルメチル等が好ましい。

(9)

【0078】多環式化合物(C4)は、例えば1,3-アダマンタンジカルボン酸ジー t-プチルの場合、窒素雰囲気下で、テトラヒドロフラン中に1,3-アダマンタンジカルボン酸を溶解し、この溶液にトリフルオロ酢酸無水物を氷冷下で滴下して、室温にて攪拌したのち、t-プタノールのテトラヒドロフラン溶液を氷冷下で滴下し、例えば一終夜室温で攪拌して反応させることにより合成することができる。また、1,3-アダマンタンジカルボン酸ジー<math>t-プトキシカルボニルメチルの場合は、テトラヒドロフラン中で、1,3-アダマンタンジカルボン酸とプロモ酢酸<math>t-プチルとを、炭酸カリウム 触媒の存在下で反応させることにより合成することができる。

【0079】次に、脂環式化合物(C5)において、2 の環構成炭素原子の合計数が6~20の多環式炭素環を有するm価の炭化水素基としては、例えば、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダマンタンや、下記式(ii)で表される基等の多環式炭素環に由来する基;

10 [0080]

【化28】

【0081】これらの多環式炭素環を、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル 50 基、t-ブチル基等の炭素数1~8の直鎖状、分岐状ま

たは環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基に由来する炭化水素基等を挙げることができる。多環式化合物(C5)において、m個の基-OCOC, H, COOCH, COOR は、前記m価の炭化水素基中の多環式炭素環に結合しても、あるいは該多環式炭素環を置換するアルキル基に結合してもよい。

【0082】また、乙の環構成炭素原子の合計数が6~ 20の多環式炭素環を有するm価の炭化水素基の誘導体 としては、例えば、ヒドロキシル基:カルボキシル基: オキソ基;ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、 1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル 基、3-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシブチル 基、2-ヒドロキシプチル基、3-ヒドロキシブチル 基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロ キシアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、n-プロポ キシ基、i-プロポキシ基、n-ブトキシ基、2-メチ ルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ基、t-プトキ シ基等の炭素数1~4のアルコキシル基:メトキシカル ボニル基、エトキシカルボニル基、n-プロポキシカル 20 ボニル基、i-プロポキシカルボニル基、n-プトキシ カルボニル基、2-メチルプロポキシカルボニル基、1 ーメチルプロポキシカルボニル基、 t ープトキシカルボ ニル基等の炭素数2~5のアルコキシカルボニル基;メ トキシカルボニルメトキシカルボニル基、エトキシカル ボニルメトキシカルボニル基、n-プロポキシカルボニ ルメトキシカルボニル基、 i - プロポキシカルボニルメ トキシカルボニル基、n-プトキシカルボニルメトキシ カルボニル基、2-メチルプロポキシカルボニルメトキ シカルボニル基、1-メチルプロポキシカルボニルメト 30 キシカルボニル基、 t ープトキシカルボニルメトキシカ

ルボニル基等の炭素数 4~7のアルコキシカルボニルメトキシカルボニル基等の置換基を1種以上あるいは1個以上有する基を挙げることができる。これらの置換基は、前記n価の炭化水素基中の多環式炭素環に結合しても、あるいは該多環式炭素環を置換するアルキル基に結合してもよい。

【0083】前記置換基のうち、ヒドロキシル基、1-メチルプロポキシカルボニルメトキシカルボニル基等が好まして、特にヒドロキシル基が好ましい。また、多環式化合物(C5)におけるmとしては、1または2が好ましい。なお、置換基として(1-分岐アルコキシ)-COCH:-OCO基を有する場合、その1-分岐アルコキシ)-COCH:とOCOとの間も、酸の存在下で解離しうる。

【0084】多環式化合物(C5)の具体例としては、 下記式(5-1)~(5-44)で表される化合物等を挙げる ことができる。

[0085]

【化29】

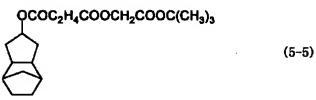
[0086] [化30]

OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
(5-3)
OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃

CH₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
(5-4)
CH₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃

[0087]

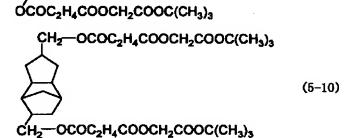
【化31】



[0088] [化32] (佐33] (5-7) OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃

(5-8)

H₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
(5-9)



[0 0 9 0] [化 3 4] OCOC₂H₄COOC(CH₃)₃ (6-11)

50

【化35】

[0095]

OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
(5-13)
OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃

CH₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
(5-14)
CH₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃

[0092] [化36] OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃ (5-15) CH₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃

CH₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
(5-16)

CH₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
(5-18)

CH₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃

[(化38] OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
(5-19)

OCOC2H4COOCH2COOC(CH3)3

CH₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
(5-20)
CH₂—OCOC₂H₄COOCH₂COOC(CH₃)₃
(H₂ 3 9]

36 QCOC2H4COOCH2COOC(CH3)3 (CH₃)₃COCOCH₂OCOC₂H₄COO OCOC2H4COOCH2COOC(CH3)3 (CH₃)₃COCOCH₂OCOC₂H₄COO (5-21)

[0096]

[0097]

[0098]

【化42】 CH2-COOCH2COOC(CH3)3 CH2-COOH H₃Ç

(5-27)

CH2-COOCH2COOC(CH3)3 CH₂-COOCH₂COOC(CH₃)₃ Н₃С (5-28)

[0099] 【化43】

CH2-COOCH2COOC(CH3)3 ÇH²-COOH H₃Ç COOCH₂COOC(CH₃)₃ (5-29)

CH2-COOCH2COOC(CH3)3 o=ċ Н₃С `СH₂-СООСН₂СООС(СН₃)₃ COOCH2COOC(CH3)3

(5-30)

[0100] 【化44】

[0101]

[0102]

[0103]

【化47】

(5-35)

[0104]

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-COOCH}_2\text{COOC}(\text{CH}_3)_3 \\ \text{CH}_2 \\ \text{O=C} \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH-CH}_2 \\ \text{CH}_2\text{-COOCH}_2\text{COOC}(\text{CH}_3)_3 \\ \text{OH}_2\text{C} \\ \text{COOCH}_2\text{COOC}(\text{CH}_3)_3 \\ \end{array}$$

[0105]

44 H2-COOCH2COOC(CH3)3 CH₃ CH2-COOH H₃Ç CH2-CH2-COOCH2COOC(CH3)3 (5-41)

[0106]

【化50】 CH2-COOCH2COOC(CH3)3 ÇH₃ CH2-COOH Ӊ₃Ҫ CH2-CH2-COOCH2COOC(CH3)3 COOCH2COOC(CH3)3 (5-43)

【0107】これらの多環式化合物 (C5) のうち、式 (5-9)、式(5-10)、式(5-13)、式(5-14)、式 (5-17)、式(5-18)、式(5-21)、式(5-22)、式 (5-24)、式 (5-30)または式 (5-44)で表される化合 物等が好ましく、特に、式 (5-10)、式 (5-17)、式 (5-21)、式(5-24)、式(5-30)または式(5-44)で 表される化合物等が好ましい。

【0108】多環式化合物(C5)は、例えば、脂環式 炭素環を有するアルコールと無水こはく酸とを反応さ せ、その反応生成物にさらにプロモ酢酸 t ープチルを反 応させることにより合成することができる。より具体的 には、例えば前記式 (5-30)で表される化合物は、窒素 50

雰囲気下、酢酸nープチル中で、デオキシコール酸と無 40 水こはく酸とを、還流下にて反応させ、析出した白色固 体を酢酸nープチルに溶解して数回水洗したのち、溶剤 を留去し、その後テトラヒドロフラン、蒸留水、炭酸カ リウムおよびプロモ酢酸 t ープチルを加えて、数時間反 応させることにより合成することができる。

【0109】次に、多環式化合物(C6)の具体例とし ては、下記式 (6-1) ~ (6-29)で表される化合物等を 挙げることができる。

[0110]

【化51】

[0113]

【化54】

(6-5)

(25) 特開2002-311590 47 COOCH₃ COOC₂H₅ COOC₂H₅ COOCH₃ (6-13)(6-14)[0117] 【化58】 ÇH₃ COO(CH₂)₂CH₃ COO(CH₂)₂CH₃ COOÇHCH3 ĊH₃ (6-15)(6-16)[0118] 【化59】 ÇH₃ сооснс₂н₅ COOC(CH₃)₃ COOC(CH₃)₃ COOCHC2H5 ĊH₃ (6-17)(6-18)[0119] 【化60】 (6-19)(6-20)[0120] 【化61】 COOCH₂COOH COOCH2COOCH3 COOCH2COOH COOCH2COOCH3 (6-21) (6-22)[0121] COOCH2COOC2H5

$$\begin{array}{c} \text{COOCH}_2\text{COO(CH}_2\text{)}_2\text{CH}_3\\ \\ \text{COOCH}_2\text{COO(CH}_2\text{)}_2\text{CH}_3 \end{array} \tag{6-24} \\ \end{array}$$

【化62】

[0122] 50

【化63】

[0123] 【化64】

[0124] 【化65】

【0125】これらの多環式化合物 (C6) のうち、特 に、式 (6-18)または式 (6-27)で表される化合物等が 好ましい。

【0126】多環式化合物 (C6) のうち、式 (6-1) で表される化合物は入手可能であり、それ以外の多環式 化合物(C6)は、式(6-1)で表される化合物を出発 物質として合成することができる。例えば、式 (6-18) で表される化合物は、式(6-1)で表される化合物と力 リウム t -プトキシドとを、塩化チオニル等の触媒の存 在下、髙温にて反応させることにより合成することがで き、また式 (6-27)で表される化合物は、式 (6-1) で 表される化合物とプロモ酢酸 t - プチルとを、炭酸カリ ウム等の触媒の存在下で反応させることにより合成する ことができる。

【0127】次に、多環式化合物(C7)において、R ''およびR''の結合位置は、nおよびpが0の場合は、

オキシ基あるいは2価のオキシカルポニル基の位置を2 -位としたとき、5-位または6-位にあり、nおよび pが1の場合は、一般式(7)中の2つの炭素環を結ぶ 2価のカルボニルオキシ基あるいは2価のオキシカルボ ニル基の位置を3-位としたとき、8-位または9-位 にあり、さらにnおよびpが2の場合は、一般式(7) 中の2つの炭素環を結ぶ2価のカルボニルオキシ基ある いは2価のオキシカルポニル基の位置を3-位としたと き、10-位または11-位にある。

【0128】多環式化合物(C7)において、R''およ びR12の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキ ル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロ ピル基、i-プロピル基、n-プチル基、2-メチルプ ロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等を挙 げることができる。また、R''fおよびR''の炭素数1~ 4の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシアルキル基とし ては、例えば、ヒドロキシメチル基、2-ヒドロキシエ チル基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプ ロピル基、3-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシ 20 プチル基、2-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブ チル基、4-ヒドロキシブチル基等を挙げることができ

【0129】また、R''およびR''の-OR''のうち、 R¹³が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル 基である基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ 基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-プトキ シ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ 基、t-プトキシ基等を挙げることができる。また、R ''およびR''の-OR''のうち、R''が-CH, COO 30 R¹¹である基としては、例えば、カルボキシメトキシ基 や、メトキシカルボニルメトキシ基、エトキシカルボニ ルメトキシ基、n-プロポキシカルボニルメトキシ基、 iープロポキシカルポニルメトキシ基、nープトキシカ ルポニルメトキシ基、2-メチルプロポキシカルポニル メトキシ基、1-メチルプロポキシカルボニルメトキシ 基、tープトキシカルポニルメトキシ基、nーペンチル オキシカルポニルメトキシ基、n-ヘキシルオキシカル ボニルメトキシ基、n-オクチルオキシカルボニルメト キシ基、n-デシルオキシカルポニルメトキシ基、n-ドデシルオキシカルボニルメトキシ基、n-テトラデシ ルオキシカルポニルメトキシ基、n-ヘキサデシルオキ シカルポニルメトキシ基、n-オクタデシルオキシカル ポニルメトキシ基、シクロペンチルオキシカルボニルメ トキシ基、シクロヘキシルオキシカルポニルメトキシ 基、シクロオクチルオキシカルポニルメトキシ基等の直 鎖状、分岐状もしくは環状のアルコキシカルポニルメト キシ基を挙げることができる。

【0130】また、R''およびR''の-COOR''のう ち、R! が置換もしくは非置換の炭素数1~20のアル 一般式(7)中の2つの炭素環を結ぶ2価のカルポニル 50 キル基である基としては、例えば、メトキシカルポニル

基、エトキシカルボニル基、n-プロポキシカルボニル 基、i-プロポキシカルボニル基、n-プトキシカルボ ニル基、2-メチルプロポキシカルボニル基、1-メチ ルプロポキシカルボニル基、 t ープトキシカルボニル 基、n-ペンチルオキシカルボニル基、n-ヘキシルオ キシカルボニル基、n-オクチルオキシカルボニル基、 nーデシルオキシカルボニル基、nードデシルオキシカ ルポニル基、n-テトラデシルオキシカルポニル基、n - ヘキサデシルオキシカルボニル基、n-オクタデシル オキシカルボニル基、n-エイコシルオキシカルボニル 10 基、シクロペンチルオキシカルボニル基、シクロヘキシ ルオキシカルボニル基、シクロオクチルオキシカルボニ ル基等の直鎖状、分岐状もしくは環状の非置換アルコキ シカルボニル基; これらの非置換アルコキシカルボニル 基中のアルコキシル基を、ヒドロキシル基、カルボキシ ル基、オキソ基、ヒドロキシメチル基、炭素数1~4の 直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基等の置換基の1 種以上あるいは1個以上で置換した誘導体を挙げること ができる。

【0131】また、R''およびR''の-COOR''のう 20 ち、R''が-CH、COOR''である基としては、例えば、カルボキシメトキシカルボニル基や、メトキシカルボニルメトキシカルボニル基、ロープロポキシカルボニルメトキシカルボニル基、ロープロポキシカルボニルメトキシカルボニル基、ロープトキシカルボニルメトキシカルボニル基、2-メチルプロポキシカルボニルメトキシカルボニル基、1-メチルプロポキシカルボニルメトキシカルボニル基、1-メチルプロポキシカルボニルメトキシカルボニル基、ローペンチルオキシカルボニルメトキシカルボニル基、ローペンチルオキシカルボニルメトキシカルボニル基、ローペキシルオキシカルボニルメトキシカルボニル基、ローオクチルオキシカルボニルメトキシカルボニル

基、n-デシルオキシカルボニルメトキシカルボニル 基、n-ドデシルオキシカルボニルメトキシカルボニル 基、n-テトラデシルオキシカルボニルメトキシカルボニル基、n-ヘキサデシルオキシカルボニルメトキシカ ルボニル基、n-オクタデシルオキシカルボニルメトキ シカルボニル基、シクロペンチルオキシカルボニルメト キシカルボニル基、シクロペンチルオキシカルボニルメト キシカルボニル基、シクロオクチルオキシカルボニル メトキシカルボニル基等の直鎖状、分岐状もしくは環状 のアルコキシカルボニルメトキシカルボニル基を挙げる ことができる。

【0132】多環式化合物(C7)におけるR''およびR''としては、それぞれ、水素原子、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシル基、tープトキシカルボニルメトキシ基、tープトキシカルボニル基等が好ましい。また、多環式化合物(C7)におけるnおよびpとしては、それぞれ、0または1が好ましい。

【0133】多環式化合物(C7)の具体例としては、 20 下記式(7-1)~(7-208)で表される化合物等を挙げ ることができる。

[0134]

【化66】

30 [0135] [化67]

[0136]

[0137]

【化69】

[0138]

[0139]

[0140]

[0141]

COOCH₂COOC(CH₃)₃

[0142]

[0143]

50 【化75】

$$(CH_3)_3COCOCH_2O$$
 $COOCH_2COOC(CH_3)_3$
 $(7-28)$

[0148] 【化80】

[0150] [化82] 58

$$(CH_3)_3COCO$$
 $COOC(CH_3)_3$
 $(7-34)$

$$\begin{array}{c|c} \mathsf{COOCH_2COOH} \\ \mathsf{COOCH_2COOC}(\mathsf{CH_3})_3 \end{array} \tag{7-40}$$

$$(CH_3)_3COCOCH_2OCO - COOC(CH_3)_3 - COOC(CH_3)_3 - (7-42)$$

[0157] [化89]

61

(7-47)COOCH2COOH

[0158] 【化90】

COOCH2COOH (7-55)

(7-53)

(7-56)【化95】

[0162] 【化94】

СООН

(7-57)

(7-59)COOCH2COOH

$$H_3C$$
 $COOC(CH_3)_3$
 $(7-58)$

[0163]

[0164] 【化96】 50

$$HOCH_2$$
 $COOCH_2COOC(CH_3)_3$ $(7-64)$

【化101】

$$H_3CO$$
 $COOCH_2COOC(CH_3)_3$
 $(7-72)$

68

$$(CH_3)_3COCO$$
 $COOC(CH_3)_3$ $(7-86)$

$$(CH_3)_3COCO$$
 $COOCH_2COOC(CH_3)_3$
 $(7-88)$

$$(CH_3)_3COCOCH_2OCO - COOC(CH_3)_3 - (7-94)$$

$$(CH_3)_3COCOCH_2OCO \longrightarrow COOCH_2COOC(CH_3)_3$$

$$(CH_3)_3COCOCH_2COOC(CH_3)_3 \qquad (7-96)$$

[0183]

50 【化115】

[0189]

[0190]

[0191]

[0192]

【化124】

[0198]

78

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

$$(CH_3)_3COCOCH_2O \longrightarrow COOC(CH_3)_3$$

$$COOC(CH_3)_3 \qquad (7-130)$$

[0201] 50 [化133]

80

(7-144)

$$(CH_3)_3COCO - COOC(CH_3)_3$$
 $(7-138)$

$$(CH_3)_3COCO$$
 $COOC(CH_3)_3$
 $(7-140)$
 $COOCH_2COOC(CH_3)_3$

COOCH2COOC(CH3)3

[0210]

【化142】

COOH

COOC(CH₃)₃

COOCH₂COOH

$$\begin{array}{c|c} \mathsf{HOCH_2} & \mathsf{COO} & \mathsf{CH_2OH} \\ \\ \mathsf{COOCH_2COOC}(\mathsf{CH_3})_3 \end{array} \tag{7-168}$$

HOCOCH₂O
$$\longrightarrow$$
 COOC(CH₃)₃ \bigcirc (7-178)

$$(CH_3)_3COCOCH_2O \longrightarrow COOCH_2COOC(CH_3)_3$$

$$(CH_3)_3COCOCH_2O \longrightarrow COOCH_2COOC(CH_3)_3$$

$$(7-184)$$

[0228]

50 【化160】

92

(7-198)

$$(CH_3)_3COCO$$
 $COOC(CH_3)_3$
 $COOC(CH_3)_3$

$$(CH_3)_3COCO \longrightarrow COOC(CH_3)_3$$

$$(COOCH_2COOC(CH_3)_3$$

$$(7-192)$$

$$(CH_3)_3CO \underbrace{\begin{array}{c} H_2 \\ C \\ C \end{array}}_{C}C \underbrace{\begin{array}{c} H_2 \\ C \\ C \end{array}}_{C}C(CH_3)_3$$

[0236]

[0237]

【化169】

HO COOCH₂COOC (CH₃)₃ (7-207)
$$COOCH2COOC(CH3)3$$

【0238】これらの多環式化合物(C7)のうち、式 (7-9)、式(7-10)、式(7-12)、式(7-13)、式 (7-14)、式 (7-16)、式 (7-25)、式 (7-26)、式 (7-28)、式 (7-33)、式 (7-34)、式 (7-36)、式 (7-41)、式 (7-42)、式 (7-44)、式 (7-45)、式 (7-46)、式 (7-48)、式 (7-49)、式 (7-50)、式 (7-52)、式 (7-61)、式 (7-62)、式 (7-64)、式 (7-65)、式 (7-66)、式 (7-68)、式 (7-77)、式 (7-78)、式(7-80)、式(7-85)、式(7-86)、式 (7-88)、式(7-93)、式(7-94)、式(7-96)、式 (7-97)、式(7-98)、式(7-100)、式(7-101)、 式 (7-102)、式 (7-104)、式 (7-113)、式 (7-1 14)、式 (7-116)、式 (7-117)、式 (7-118)、式 (7-120)、式(7-129)、式(7-130)、式(7-13 2) 、式 (7-137) 、式 (7-138) 、式 (7-140) 、式 (7-145)、式(7-146)、式(7-148)、式(7-14 9) 、式 (7-150) 、式 (7-152) 、式 (7-153) 、式 (7-154)、式(7-156)、式(7-165)、式(7-16 6) 、式 (7-168) 、式 (7-169) 、式 (7-170) 、式 (7-172)、式(7-181)、式(7-182)、式(7-18 4)、式(7-189)、式(7-190)、式(7-192)、式 (7-197)、式(7-198)、式(7-200)、式(7-20 1) 、式 (7-202)、式 (7-204) 、式 (7-205) 、式 (7-206) または式 (7-208) で表される化合物等が好 ましく、特に、式 (7-34)、式 (7-104)、式 (7-13 2) または式 (7-169) で表される化合物等が好まし 41.

【0239】多環式化合物(C7)は、例えば、前記式(7-103)で表される化合物の場合、ジシクロペンタジエンと酢酸アリルとをディールスーアルダー反応させ、得られた反応生成物に蟻酸を付加反応させたのち、テトラヒドロフラン中にて、トリエチルアミンおよび4ージメチルアミノピリジンの存在下で、ハイミック酸を反応させ、この反応生成物に蟻酸をさらに付加反応させ、その後水酸化カリウム水溶液で加水分解して合成することができる。

【0240】次に、多環式化合物(C8)において、R¹⁷、R¹⁸、R¹⁹およびR¹⁰の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、

エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-プチ ル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、 t-プチル基等を挙げることができる。また、R'1、R 「『、R」。およびR』。の炭素数1~4の直鎖状もしくは分 岐状のアルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、 エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n -プトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプ ロポキシ基、tープトキシ基等を挙げることができる。 多環式化合物(C8)におけるR''、R''、R''および 20 R¹⁰としては、水素原子、ヒドロキシル基、メチル基、 エチル基、メトキシ基、エトキシ基等が好ましい。 【0241】多環式化合物(C8)の具体例としては、 テトラヒドロアビエチン酸、テトラヒドロアビエチン酸 メチル、テトラヒドロアピエチン酸エチル、テトラヒド ロアピエチン酸n-プロピル、テトラヒドロアピエチン 酸 i ープロピル、テトラヒドロアピエチン酸 n ープチ ル、テトラヒドロアビエチン酸2-メチルプロピル、テ トラヒドロアビエチン酸1-メチルプロピル、テトラヒ ドロアピエチン酸 t ープチル、テトラヒドロアピエチン

【0242】テトラヒドロアビエチン酸メトキシカルボニルメチル、テトラヒドロアビエチン酸エトキシカルボニルメチル、テトラヒドロアビエチン酸 n ープロポキシカルボニルメチル、テトラヒドロアビエチン酸 i ープロポキシカルボニルメチル、テトラヒドロアビエチン酸 n ーブトキシカルボニルメチル、テトラヒドロアビエチン酸 2 ーメチルプロポキシカルボニルメチル、テトラヒドロアビエチン 酸 1 ーメチルプロポキシカルボニルメチル、テトラヒドロアビエチン酸 t ープトキシカルボニルメチル、テトラヒドロアビエチン酸シクロペンチルオキシカルボニルメチル、テトラヒドロアビエチン酸シクロペンチルオキシカルボニルメチル、テトラヒドロアビエチン酸シクロペキシルオキシカルボニルメチル等のテトラヒドロアビエチン酸のアルコキシカルボニルメチルエステル類や、下記式(8-1)~(8-30)で表される化合物等を挙げることができる。

30 酸シクロペンチル、テトラヒドロアピエチン酸シクロへ

キシル等のテトラヒドロアビエチン酸またはそのアルキ

[0243]

40

ルエステル類:

【化170】

(8-2)

[0244]

[0245]

[0246]

[0247]

【化174】

CH₃ CH—CH₃ O(CH₂)₃CH₃ H₃C COOH (8-9) (8-10)

[0248]

[0249]

[0250]

[0251]

[0252]

50 【化179】

101

H₃C COOC(CH₃)₃
(8-19)

CH₃ CH—CH₃ CH₃ CH₃ CH₃ (8-20)

[0253]

H₃C COOC(CH₃)₃

(8-21)

10 【化 1 8 0】 CH₃ CH—CH₃ OH (8-22)

[0254]

[0255]

[0256]

【化183】

104 .

[0257]

【0258】これらの多環式化合物 (C8) のうち、特 20 に、テトラヒドロアピエチン酸 t ープチル、テトラヒドロアピエチン酸 t ープトキシカルボニルメチル等が好ましい。

【0259】多環式化合物(C8)は、例えば、テトラヒドロアビエチン酸 t - プチルの場合、テトラヒドロアビエチン酸とカリウム t - プトキシドとを、塩化チオニル等の触媒の存在下、高温にて反応させることにより合成することができ、またテトラヒドロアビエチン酸 t - プトキシカルボニルメチルは、テトラヒドロアビエチン酸とプロモ酢酸 t - プチルとを、炭酸カリウム等の触媒 30の存在下で反応させることにより合成することができる。

【0260】次に、多環式化合物(C9)の具体例とし ては、リトコール酸、リトコール酸メチル、リトコール 酸エチル、リトコール酸n-プロピル、リトコール酸i ープロピル、リトコール酸 n ープチル、リトコール酸 2 -メチルプロピル、リトコール酸1-メチルプロピル、 リトコール酸 t ープチル、リトコール酸シクロペンチ ル、リトコール酸シクロヘキシル、リトコール酸ィープ チロラクトン、リトコール酸メバロニックラクトン、リ 40 トコール酸メトキシカルボニルメチル、リトコール酸エ トキシカルポニルメチル、リトコール酸nープロポキシ カルボニルメチル、リトコール酸 i - プロポキシカルボ ニルメチル、リトコール酸 n - ブトキシカルボニルメチ ル、リトコール酸2-メチルプロポキシカルボニルメチ ル、リトコール酸1-メチルプロポキシカルポニルメチ ル、リトコール酸 t ープトキシカルポニルメチル、リト コール酸シクロペンチルオキシカルポニルメチル、リト コール酸シクロヘキシルオキシカルポニルメチル等のリ トコール酸またはその誘導体類:

【0261】デオキシコール酸、デオキシコール酸メチ ル、デオキシコール酸エチル、デオキシコール酸n-プ ロピル、デオキシコール酸 i - プロピル、デオキシコー ル酸nープチル、デオキシコール酸2-メチルプロピ ル、デオキシコール酸1-メチルプロピル、デオキシコ ール酸 t - プチル、デオキシコール酸シクロペンチル、 デオキシコール酸シクロヘキシル、デオキシコール酸ィ -プチロラクトン、デオキシコール酸メバロニックラク トン、デオキシコール酸メトキシカルボニルメチル、デ オキシコール酸エトキシカルボニルメチル、デオキシコ ール酸n-プロポキシカルボニルメチル、デオキシコー ル酸 i - プロポキシカルボニルメチル、デオキシコール 酸n-ブトキシカルボニルメチル、デオキシコール酸2 ーメチルプロポキシカルボニルメチル、デオキシコール 酸1-メチルプロポキシカルボニルメチル、デオキシコ ール酸 t ープトキシカルポニルメチル、デオキシコール 酸シクロペンチルオキシカルボニルメチル、デオキシコ ール酸シクロヘキシルオキシカルボニルメチル等のデオ キシコール酸またはその誘導体類:

【0262】ウルソデオキシコール酸、ウルソデオキシ 40 コール酸メチル、ウルソデオキシコール酸エチル、ウル ソデオキシコール酸 n - プロピル、ウルソデオキシコー ル酸 i - プロピル、ウルソデオキシコール酸 n - ブチ ル、ウルソデオキシコール酸 2 - メチルプロピル、ウル ソデオキシコール酸 1 - メチルプロピル、ウルソデオキ シコール酸 t - ブチル、ウルソデオキシコール酸シクロ ベンチル、ウルソデオキシコール酸シクロへキシル、ウ ルソデオキシコール酸 r - ブチロラクトン、ウルソデオ キシコール酸メバロニックラクトン、ウルソデオキシコー ル酸メトキシカルボニルメチル、ウルソデオキシコー ル酸エトキシカルボニルメチル、ウルソデオキシコール

では、特に、ライン・アンド・スペースパターンの疎密 度によるラインパターンの線幅の変動に対する改良効果

106

が不十分となるおそれがあり、一方20重量部を超える

【0268】本発明の感放射線性樹脂組成物には、露光

により酸発生剤(B)から生じる酸のレジスト被膜中に

おける拡散現象を制御し、非露光領域における好ましく

と、耐熱性や基板への接着性が低下する傾向がある。

酸 n - プロポキシカルボニルメチル、ウルソデオキシコ ール酸 i - プロポキシカルボニルメチル、ウルソデオキ シコール酸nープトキシカルボニルメチル、ウルソデオ キシコール酸2-メチルプロポキシカルボニルメチル、 ウルソデオキシコール酸1-メチルプロポキシカルボニ ルメチル、ウルソデオキシコール酸 t - プトキシカルボ ニルメチル、ウルソデオキシコール酸シクロペンチルオ キシカルボニルメチル、ウルソデオキシコール酸シクロ ヘキシルオキシカルボニルメチル等のウルソデオキシコ ール酸またはその誘導体類;

ない化学反応を抑制する作用を有する酸拡散制御剤を配 合することが好ましい。このような酸拡散制御剤を配合 10 することにより、得られる感放射線性樹脂組成物の保存 安定性がさらに向上し、またレジストとしての解像度が さらに向上するとともに、露光から露光後の加熱処理ま での引き置き時間(PED)の変動によるレジストパタ ーンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性に 極めて優れた組成物が得られる。酸拡散制御剤として は、レジストパターンの形成工程中の露光や加熱処理に より塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。 このような含窒素有機化合物としては、例えば、下記一 般式(10) [0269]【化185】

【0263】コール酸、コール酸メチル、コール酸エチ ル、コール酸n-プロピル、コール酸i-プロピル、コ ール酸n-ブチル、コール酸2-メチルプロピル、コー ル酸1-メチルプロピル、コール酸 t - プチル、コール 酸シクロペンチル、コール酸シクロヘキシル、コール酸 γープチロラクトン、コール酸メパロニックラクトン、 コール酸メトキシカルボニルメチル、コール酸エトキシ カルボニルメチル、コール酸n-プロポキシカルボニル メチル、コール酸 i ープロポキシカルボニルメチル、コ ール酸n-プトキシカルボニルメチル、コール酸2-メ 20 チルプロポキシカルボニルメチル、コール酸1-メチル プロポキシカルボニルメチル、コール酸 t - プトキシカ ルボニルメチル、コール酸シクロペンチルオキシカルボ ニルメチル、コール酸シクロヘキシルオキシカルボニル メチル等のコール酸またはその誘導体類等を挙げること ができる。

(10)

【0264】これらの多環式化合物 (C9) のうち、リ トコール酸 t-プチル、リトコール酸 $\gamma-$ プチロラクト ン、リトコール酸 t - プトキシカルボニルメチル、デオ キシコール酸 t ープチル、デオキシコール酸 γ ープチロ 30 ラクトン、デオキシコール酸 t ープトキシカルボニルメ チル、ウルソデオキシコール酸 t - ブチル、ウルソデオ キシコール酸ャープチロラクトン、ウルソデオキシコー ル酸 t - プトキシカルポニルメチル、コール酸 t - プチ ル、コール酸γ-ブチロラクトン、コール酸 t - プトキ シカルボニルメチル等が好ましい。

〔一般式(10) において、R'4、R'1 およびR'1 は相 互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の直鎖状、分 岐状もしくは環状のアルキル基、置換もしくは非置換の アリール基または置換もしくは非置換のアラルキル基を 示す。〕

【0265】多環式化合物 (C9) は、例えば、対応す るステロイドカルボン酸を、炭酸カリウムの存在下で、 プロム酢酸 tープチル等と反応させることにより合成す ることができる。

【0270】で表される化合物(以下、「含窒素化合物 (イ)」という。)、同一分子内に窒素原子を2個有す る化合物(以下、「含窒素化合物(ロ)」という。)、 窒素原子を3個以上有するポリアミノ化合物や重合体 (以下、これらをまとめて「含窒素化合物(ハ)」とい う。)、アミド基含有化合物、ウレア化合物、含窒素複 素環化合物等を挙げることができる。

【0266】本発明における多環式化合物(C)として は、多環式化合物(C5)、多環式化合物(C8)、多 環式化合物 (C9) 等が好ましく、特に好ましくは多環 式化合物(C9)である。

【0271】含窒素化合物(イ)としては、例えば、n - ヘキシルアミン、n - ヘプチルアミン、n - オクチル アミン、n-ノニルアミン、n-デシルアミン、シクロ ヘキシルアミン等のモノアルキルアミン類:ジ-n-ブ チルアミン、ジーnーペンチルアミン、ジーnーヘキシ ルアミン、ジーnーヘプチルアミン、ジーnーオクチル アミン、ジーn-ノニルアミン、ジーn-デシルアミ ン、シクロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘキシルア ミン等のジアルキルアミン類:トリエチルアミン、トリ -n-プロピルアミン、トリ-n-プチルアミン、トリ -n-ペンチルアミン、トリ-n-ヘキシルアミン、ト リーnーヘプチルアミン、トリーnーオクチルアミン、 トリーnーノニルアミン、トリーnーデシルアミン、シ クロヘキシルジメチルアミン、メチルジシクロヘキシル

【0267】本発明において、多環式化合物(C)は、 単独でまたは2種以上を混合して使用することができ る。多環式化合物 (C) の使用量は、樹脂 (A) 100 重量部に対して、通常、1~20重量部、好ましくは1 ~15重量部、特に好ましくは1~10重量部である。 この場合、多環式化合物 (C) の使用量が1重量部未満 50

アミン、トリシクロヘキシルアミン等のトリアルキルア ミン類;ピス(2-ジメチルアミノエチル)エーテル、 ビス (2-ジエチルアミノエチル) エーテル等のビス (ジアルキルアミノアルキル) エーテル類; アニリン、 N-メチルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニ リン、2, 6-ジーt-ブチルアニリン、2, 6-ジー tープチルーNーメチルアニリン、2,6ージーtーブ チル-N, N-ジメチルアニリン、4-ニトロアニリ ン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、ナフチル 10 アミン等の芳香族アミン類を挙げることができる。

【0272】含窒素化合物(ロ)としては、例えば、エ チレンジアミン、N, N, N', N' - テトラメチルエチ レンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレ ンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、 4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、4, 4'-ジ アミノベンゾフェノン、4,4'ージアミノジフェニル アミン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパ ン、2-(3-アミノフェニル)-2-(4-アミノフ エニル) プロパン、2 - (4 - アミノフェニル) - 2 - 20(3-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-(4-アミ ノフェニル) -2- (4-ヒドロキシフェニル) プロパ ン、1, 4-ビス〔1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル〕ベンゼン、1,3-ビス〔1-(4-ア ミノフェニル) -1-メチルエチル) ベンゼン、ビス (2-ジメチルアミノエチル) エーテル、ビス (2-ジ エチルアミノエチル)エーテル等を挙げることができ る。含窒素化合物(ハ)としては、例えば、ポリエチレ ンイミン、ポリアリルアミン、2-ジメチルアミノエチ ルアクリルアミドの重合体等を挙げることができる。

【0273】前記アミド基含有化合物としては、例え ば、N-t-プトキシカルボニルジ-n-オクチルアミ ン、N-t-プトキシカルポニルジ-n-ノニルアミ ン、N-t-プトキシカルボニルジ-n-デシルアミ ン、N-t-プトキシカルポニルジシクロヘキシルアミ ン、N-t-プトキシカルポニル-1-アダマンチルア ミン、N-t-プトキシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミン、N, N-ジ-t-プトキシカルボ ニルー1-アダマンチルアミン、N, N-ジ-t-プト キシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミ ン、N-t-プトキシカルポニル-4, 4'-ジアミノ ジフェニルメタン、N, N' - ジ - t - プトキシカルボニルヘキサメチレンジアミン、N, N, N' N' ーテト ラーtープトキシカルポニルヘキサメチレンジアミン、 N, N'ージーtープトキシカルボニルー1. 7ージア ミノヘプタン、N, N'ージーtープトキシカルボニル キシカルポニル-1, 9-ジアミノノナン、N, N'-ジー t ープトキシカルポニルー 1, 10 ージアミノデカ

ージアミノドデカン、N, N'ージーtープトキシカル ポニルー4, 4'ージアミノジフェニルメタン、N-t ープトキシカルボニルベンズイミダゾール、N-t-ブ トキシカルボニルー2-メチルベンズイミダゾール、N - t - プトキシカルボニル-2-フェニルペンズイミダ ゾール等のN-t-ブトキシカルボニル基含有アミノ化 合物のほか、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、 N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メ チルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プ ロピオンアミド、ベンズアミド、ピロリドン、Nーメチ ルピロリドン等を挙げることができる。

【0274】前記ウレア化合物としては、例えば、尿 素、メチルウレア、1,1-ジメチルウレア、1,3-ジメチルウレア、1,1,3,3-テトラメチルウレ ア、1,3-ジフェニルウレア、トリーn-プチルチオ ウレア等を挙げることができる。前記含窒素複素環化合 物としては、例えば、イミダゾール、ベンズイミダゾー ル、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニ ルイミダゾール、N-t-プトキシカルボニル-2-フ ェニルベンズイミダゾール等のイミダゾール類:ピリジ ン、2-メチルピリジン、4-メチルピリジン、2-エ チルピリジン、4-エチルピリジン、2-フェニルピリ ジン、4-フェニルピリジン、2-メチル-4-フェニ ルピリジン、ニコチン、ニコチン酸、ニコチン酸アミ ド、キノリン、4-ヒドロキシキノリン、8-オキシキ **ノリン、アクリジン、2,2':6',2''-ターピリジン** 等のピリジン類;ピペラジン、1-(2-ヒドロキシエ チル)ピペラジン等のピペラジン類のほか、ピラジン、 ピラゾール、ピリダジン、キノザリン、プリン、ピロリ 30 ジン、ピペリジン、3-ピペリジノ-1,2-プロパン ジオール、モルホリン、4-メチルモルホリン、1、4 ージメチルピペラジン、1,4-ジアザビシクロ[2. 2. 2] オクタン等を挙げることができる。

【0275】これらの含窒素有機化合物のうち、含窒素 化合物(イ)、アミド基含有化合物、含窒素複素環化合 物が好ましく、特にN-t-プトキシカルボニル基含有 アミノ化合物が好ましい。前記酸拡散制御剤は、単独で または2種以上を混合して使用することができる。酸拡 散制御剤の配合量は、樹脂(A)100重量部に対し て、通常、15重量部以下、好ましくは10重量部以 下、さらに好ましくは5重量部以下である。この場合、 酸拡散制御剤の配合量が15重量部を超えると、レジス トとしての感度や露光部の現像性が低下する傾向があ る。なお、酸拡散制御剤の配合量が0.001重量部未 満であると、プロセス条件によっては、レジストとして のパターン形状や寸法忠実度が低下するおそれがある。 【0276】また、本発明の感放射線性樹脂組成物に は、塗布性、現像性等を改良する作用を示す界面活性剤 を配合することができる。前記界面活性剤としては、例 ン、N, N' -ジ-t-プトキシカルボニル-1, 12 50 えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキ

シエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオ レイルエーテル、ポリオキシエチレンnーオクチルフェ ニルエーテル、ポリオキシエチレンn-ノニルフェニル エーテル、ポリエチレングリコールジラウレート、ポリ エチレングリコールジステアレート等のノニオン系界面 活性剤のほか、以下商品名で、KP341 (信越化学工 業(株) 製)、ポリフローNo. 75, 同No. 95 (共栄社化学(株)製)、エフトップEF301,同E F303, 同EF352 (トーケムプロダクツ (株) 製)、メガファックスF171、同F173 (大日本イ ンキ化学工業(株)製)、フロラードFC430、同F C431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガードA G710, サーフロンS-382, 同SC-101, 同 SC-102, 同SC-103, 同SC-104, 同S C-105, 同SC-106 (旭硝子 (株) 製) 等を挙 げることができる。これらの界面活性剤は、単独でまた は2種以上を混合して使用することができる。界面活性 剤の配合量は、樹脂(A)と酸発生剤(B)との合計1 00重量部に対して、通常、2重量部以下である。さら に、前記以外の添加剤としては、ハレーション防止剤、 接着助剤、保存安定化剤、消泡剤等を挙げることができ る。

【0277】組成物溶液の調製

本発明の感放射線性樹脂組成物は、普通、その使用に際 して、全固形分濃度が、通常、5~50重量%、好まし くは10~25重量%となるように、溶剤に溶解したの ち、例えば孔径 0.2μm程度のフィルターでろ過する ことによって、組成物溶液として調製される。前記組成 物溶液の調製に使用される溶剤としては、例えば、2-プタノン、2-ペンタノン、3-メチル-2-プタノ ン、2-ヘキサノン、4-メチル-2-ペンタノン、3 ーメチルー2ーペンタノン、3,3ージメチルー2ープ タノン、2-ヘプタノン、2-オクタノン等の直鎖状も しくは分岐状のケトン類;シクロペンタノン、3-メチ ルシクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-メチルシ クロヘキサノン、2,6-ジメチルシクロヘキサノン、 イソホロン等の環状のケトン類;プロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノーn-プロピルエーテルアセテート、プロピレング 40 リコールモノーi-プロピルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールモノーn-プチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールモノー i ープチルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノーsec-ブチル エーテルアセテート、プロピレングリコールモノー t -プチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモ ノアルキルエーテルアセテート類;2~ヒドロキシプロ ピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、 2-ヒドロキシプロピオン酸n-プロピル、2-ヒドロ キシプロピオン酸i-プロピル、2-ヒドロキシプロピ 50 によって、樹脂(A)あるいは多環式化合物(C)中の

オン酸nープチル、2-ヒドロキシプロピオン酸iーブ チル、2-ヒドロキシプロピオン酸sec-ブチル、2 ーヒドロキシプロピオン酸 t ープチル等の2-ヒドロキ シプロピオン酸アルキル類;3-メトキシプロピオン酸 メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキ シプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチ ル等の3-アルコキシプロピオン酸アルキル類のほか、 【0278】n-プロピルアルコール、i-プロピルア ルコール、n - プチルアルコール、t - プチルアルコー 10 ル、シクロヘキサノール、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、 エチレングリコールモノーnープロピルエーテル、エチ レングリコールモノーnープチルエーテル、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジ エチルエーテル、ジエチレングリコールジーnープロピ ルエーテル、ジエチレングリコールジーn-プチルエー テル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノ-n-プロピルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレン グリコールモノー n ープロピルエーテル、トルエン、キ シレン、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチ ル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3-メチル酪酸メチル、3-メトキシプチ ルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルアセテ ート、3-メチル-3-メトキシブチルプロピオネー ト、3-メチル-3-メトキシブチルプチレート、酢酸 エチル、酢酸n-プロピル、酢酸n-プチル、アセト酢 酸メチル、アセト酢酸エチル、ピルビン酸メチル、ピル ピン酸エチル、N-メチルピロリドン、N, N-ジメチ ルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、ベン ジルエチルエーテル、ジーn-ヘキシルエーテル、ジエ チレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリ コールモノエチルエーテル、カプロン酸、カプリル酸、 1-オクタノール、1-ノナノール、ペンジルアルコー ル、酢酸ペンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジエチ ル、マレイン酸ジエチル、アープチロラクトン、炭酸エ チレン、炭酸プロピレン等を挙げることができる。

【0279】これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を 混合して使用することができるが、就中、直鎖状もしく は分岐状のケトン類、環状のケトン類、プロピレングリ コールモノアルキルエーテルアセテート類、2-ヒドロ キシプロピオン酸アルキル類、3-アルコキシプロピオ ン酸アルキル類、ィープチロラクトン等が好ましい。

【0280】レジストパターンの形成方法

本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジ ストとして有用である。前記化学増幅型レジストにおい ては、露光により酸発生剤(B)から発生した酸の作用

酸解離性基が解離して、カルボキシル基を生じ、その結 果、レジストの露光部のアルカリ現像液に対する溶解性 が高くなり、該露光部がアルカリ現像液によって溶解、 除去され、ポジ型のレジストパターンが得られる。本発 明の感放射線性樹脂組成物からレジストパターンを形成 する際には、組成物溶液を、回転塗布、流延塗布、ロー ル塗布等の適宜の塗布手段によって、例えば、シリコン ウエハー、アルミニウムで被覆されたウエハー等の基板 上に塗布することにより、レジスト被膜を形成し、場合 により予め加熱処理(以下、「PB」という。)を行っ 10 たのち、所定のレジストパターンを形成するように該レ ジスト被膜に露光する。その際に使用される放射線とし ては、使用される酸発生剤(B)の種類に応じて、可視 光線、紫外線、遠紫外線、X線、荷電粒子線等を適宜選 定して使用されるが、ArFエキシマレーザー(波長1 93nm)、KrFエキシマレーザー (波長248n m) あるいはF, エキシマレーザー(波長157nm) に代表される遠紫外線が好ましい。本発明においては、 露光後に加熱処理(以下、「PEB」という。) を行う ことが好ましい。このPEBにより、酸解離性基の解離 20 反応が円滑に進行する。PEBの加熱条件は、感放射線 性樹脂組成物の配合組成によって変わるが、通常、30 ~ 200 ℃、好ましくは $50\sim 170$ ℃である。

【0281】本発明においては、感放射線性樹脂組成物 の潜在能力を最大限に引き出すため、例えば特公平6-12452号公報等に開示されているように、使用され る基板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成し ておくこともでき、また環境雰囲気中に含まれる塩基性 不純物等の影響を防止するため、例えば特開平5-18 8598号公報等に開示されているように、レジスト被 30 膜上に保護膜を設けることもでき、あるいはこれらの技 術を併用することもできる。次いで、露光されたレジス ト被膜をアルカリ現像液を用いて現像することにより、 所定のレジストパターンを形成する。前記アルカリ現像 液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウ ム、炭酸ナトリウム、けい酸ナトリウム、メタけい酸ナ トリウム、アンモニア水、エチルアミン、n-プロピル アミン、ジエチルアミン、ジーn-プロピルアミン、ト リエチルアミン、メチルジエチルアミン、エチルジメチ ルアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルアンモ 40 ニウムヒドロキシド、ピロール、ピペリジン、コリン、 1,8-ジアザビシクロー[5.4.0]-7-ウンデ セン、1,5-ジアザビシクロー[4.3.0]-5-ノネン等のアルカリ性化合物の少なくとも1種を溶解し たアルカリ性水溶液が好ましい。前記アルカリ性水溶液 の濃度は、通常、10重量%以下である。この場合、ア ルカリ性水溶液の濃度が10重量%を超えると、非露光 部も現像液に溶解するおそれがあり好ましくない。

【0282】また、前記アルカリ性水溶液には、例えば 有機溶媒を添加することもできる。前記有機溶媒として 50

は、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルi ープチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノ ン、3-メチルシクロペンタノン、2,6-ジメチルシ クロヘキサノン等のケトン類;メチルアルコール、エチ ルアルコール、n-プロピルアルコール、i-プロピル アルコール、nープチルアルコール、tープチルアルコ ール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、1, 4-ヘキサンジオール、1,4-ヘキサンジメチロール 等のアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサン等 のエーテル類;酢酸エチル、酢酸 n - プチル、酢酸 i -アミル等のエステル類; トルエン、キシレン等の芳香族 炭化水素類や、フェノール、アセトニルアセトン、ジメ チルホルムアミド等を挙げることができる。これらの有 機溶媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用するこ とができる。有機溶媒の使用量は、アルカリ性水溶液に 対して、100容量%以下が好ましい。この場合、有機 溶媒の使用量が100容量%を超えると、現像性が低下 して、露光部の現像残りが多くなるおそれがある。ま た、前記アルカリ性水溶液には、界面活性剤等を適量添 加することもできる。なお、アルカリ現像液で現像した のちは、一般に、水で洗浄して乾燥する。

[0283]

【発明の実施の形態】以下、実施例を挙げて、本発明の 実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明 は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。こ こで、部は、特記しない限り重量基準である。実施例お よび比較例における各測定・評価は、下記の要領で行っ た。

Mw: 東ソー (株) 製GPCカラム (G2000HXL 2本、G3000HXL 1本、G4000HXL 1本)を用い、流量1.0ミリリットル/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) により測定した。

放射線透過率:組成物溶液を石英ガラス上にスピンコートにより塗布し、90℃に保持したホットプレート上で60秒間PBを行って形成した膜厚0.34μmのレジスト被膜について、波長193nmにおける吸光度から、放射線透過率を算出して、遠紫外線領域における透明性の尺度とした。

【0284】感度:基板として、表面に膜厚820人のARC25(プルワー・サイエンス(Brewer Science)社製)膜を形成したシリコーンウエハー(ARC25)または表面に波長193nmで反射防止効果を発揮できるように調製されたシリコンオキシナイトライド膜を形成したシリコーンウエハー(SiON)を用い、各組成物溶液を、各基板上にスピンコートにより塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを行って形成した膜厚0.34 μ mのレジスト被膜に、(株)ニコン製ArFエキシマレーザー露光装置(レンズ開口数0.

55、露光波長193nm)により、マスクパターンを 介して露光した。その後、表2に示す条件でPEBを行 ったのち、2.38重量%のテトラメチルアンモニウム ヒドロキシド水溶液により、25℃で60秒間現像し、 水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成し た。このとき、線幅160nmのライン・アンド・スペ ースパターン(1L1S)を1対1の線幅に形成する露 光量を最適露光量(ILIS)とし、この最適露光量(ILIS)を 感度とした。

疎密線幅差:線幅160nmのライン・アンド・スペー 10 スパターン(1L10S)を1対10の線幅に形成する 最適露光量(IL10S) で露光したとき、線幅160nmの ライン・アンド・スペースパターン(1L10S)にお けるラインパターンの線幅CD1と線幅160nmのラ イン・アンド・スペースパターン(111.58)にお けるラインパターンの線幅CD2とを走査型電子顕微鏡 にて測定して、CD1とCD2との差(CD1-CD 2) を疎密線幅差として、下記基準で評価した。

良好: CD1-CD2<20nm

不良: CD1-CD2≥20nm

解像度:最適露光量(ILIS)で解像される最小のレジスト パターンの寸法を、解像度とした。

【0285】合成例1

ノルボルナンラクトンメタクリレート (Xがメチレン 基、R'がメチル基、R'が水素原子である繰り返し単 位(I-1)に対応するメタクリル酸エステル)22. 50gとメタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル2 6. 36gとメタクリル酸1.15gとを、窒素置換下 で、テトラヒドロフラン150gに溶解したのち、アソ ビスイソプロピオン酸ジメチル4.14gとn-ドデシ 30 ルメルカプタン1.36gとを混合し、70℃にて4時 間重合した。その後反応溶液を冷却し、メタノール1. 5リットル中に滴下して樹脂を凝固させ、凝固した樹脂 をろ別して、洗浄したのち、真空乾燥機にて24時間乾 燥することにより、白色粉末状の樹脂45g(収率90 重量%)を得た。この樹脂は、Mwが12,000であ り、「C-NMRによる組成分析の結果、ノルポルナン ラクトンメタクリレート/メタクリル酸2-メチル-2 ーアダマンチル/メタクリル酸共重合モル比が45.3 /50.2/4.5であった。この樹脂を、樹脂 (A-1) とする。

【0286】合成例2

ノルポルナンラクトンメタクリレート11.98gとメ タクリル酸2-メチル-2-アダマンチル22.75g とメタクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル1 5. 29gとを、窒素置換下で、テトラヒドロフラン1 50gに溶解したのち、アゾピスイソプロピオン酸ジメ チル3.97gとn-ドデシルメルカプタン1.30g とを混合し、70℃にて4時間重合した。その後反応溶 脂を凝固させ、凝固した樹脂をろ別して、洗浄したの ち、真空乾燥機にて24時間乾燥することにより、白色 粉末状の樹脂42g(収率84重量%)を得た。この樹 脂は、Mwが13,000であり、'C-NMRによる 組成分析の結果、ノルボルナンラクトンメタクリレート /メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル/メタク リル酸3-ヒドロキシー1-アダマンチル共重合モル比 が25.3/44.5/30.2であった。この樹脂 を、樹脂(A-2)とする。

【0287】合成例3

シクロヘキシルラクトンメタクリレート(R³がメチル 基、R'が水素原子である繰り返し単位(I-2)に対 応するメタクリル酸エステル) 21.81gとメタクリ ル酸2-メチル-2-アダマンチル27.01gとメタ クリル酸1.18gとを、窒素置換下で、テトラヒドロ フラン150gに溶解したのち、アゾビスイソプロピオ ン酸ジメチル4.24gとn-ドデシルメルカプタン 1. 39gとを混合し、70℃にて4時間重合した。そ の後反応溶液を冷却し、メタノール1.5リットル中に 満下して樹脂を凝固させ、凝固した樹脂をろ別して、洗 浄したのち、真空乾燥機にて24時間乾燥することによ り、白色粉末状の樹脂44g(収率88重量%)を得 た。この樹脂は、Mwが12,300であり、''C-N MRによる組成分析の結果、ノルボルナンラクトンメタ クリレート/メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチ ル/メタクリル酸共重合モル比が45.2/49.8/ 5. 0であった。この樹脂を、樹脂(A-3)とする。

【0288】合成例4

ノルボルナンラクトンメタクリレート21.81gとメ タクリル酸2-エチル-2-アダマンチル27.08g とメタクリル酸1.11gとを、窒素置換下で、テトラ ヒドロフラン150gに溶解したのち、アゾビスイソプ ロピオン酸ジメチル4.01gとn-ドデシルメルカプ タン1. 31gとを混合し、70℃にて4時間重合し た。その後反応溶液を冷却し、メタノール1. 5リット ル中に滴下して樹脂を凝固させ、凝固した樹脂をろ別し て、洗浄したのち、真空乾燥機にて24時間乾燥するこ とにより、白色粉末状の樹脂40g(収率80重量%) を得た。この樹脂は、Mwが12,800であり、''C -NMRによる組成分析の結果、ノルボルナンラクトン メタクリレート/メタクリル酸2-エチル-2-アダマ ンチル/メタクリル酸共重合モル比が44.3/50. 2/5.5であった。この樹脂を、樹脂 (A-4) とす る。

【0289】合成例5

40

0 gとメタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル2 9. 0 gをテトラヒドロフラン50 gに溶解して均一溶 液とし、窒素ガスを30分吹き込んだのち、重合開始剤 液を冷却し、メタノール1.5リットル中に滴下して樹 50 としてアゾビスイソブチロニトリル2.4gを加え、6

5℃で6時間撹拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却して、テトラヒドロフラン50gで希釈して、n- ヘキサン1,000ミリリットル中に投入し、析出した樹脂をろ別して、洗浄したのち、乾燥して、樹脂を白色の粉体として得た。この樹脂は、Mwが9,700であり、 $\beta-$ メタクリロイルオキシー $\gamma-$ プチロラクトン/メタクリル酸 2- メチルー2- アダマンチル共重合モル比が 50/ 50の共重合体であった。この樹脂を、樹脂(A-5) とする。

【0290】実施例 $1\sim6$ および比較例 $1\sim5$ 表1に示す成分からなる各組成物溶液について、各種評価を行った。評価結果を、表3に示す。表1における樹脂(A-1) \sim (A-5)以外の成分は、以下のとおりである。

酸発生剤(B)

B-I: 4-n-プトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-<math>n-プタンスルホネートB-2: 4-n-プトキシ-1-ナフチルテトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-<math>n-オクタンスルホネートB-3: ピス (4-t-プチルフェニル) ヨードニウムノ 20ナフルオロ-<math>n-プタンスルホネート

B-4: ノナフルオローn - プタンスルホニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー5 - エンー2, 3 - ジカルボジイミド

多環式化合物(C)

C-1: デオキシコール酸 t ープチル

C-2: デオキシコール酸 t - プトキシカルボニルメチル

C-3: リトコール酸 t ープトキシカルボニルメチル

【0291】酸拡散制御剤

D-1: N-t-プトキシカルボニル-2-フェニルベン 10 ズイミダゾール

D-2: N-t-ブトキシカルボニルジシクロヘキシルアミン

D-3:2,2':6',2''-ターピリジン

溶剤

E-I: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

E-2:2-ヘプタノン

E-3:γ-プチロラクトン

E-4:シクロヘキサノン

[0292]

【表1】

表 1

| | | | _ | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|---------------|------------------------|
| | 樹脂(A) | 酸発生剤(B) (部) | 多環式化合物 (C) (部) | 酸盐散制酶剂 (部) | 溶 剤 |
| 実施例1 | A-1 (95) | B-1 (4) | C-1 (5) | D-1 (0, 3) | E-1 (790) E-3 (60) |
| 実施例2 | A-1 (92) | B-2 (5) | C-2 (8) | D-2 (0, 3) | E-1 (790) E-3 (60) |
| 実施例3 | A-2 (96) | B-3 (2) B-4 (3) | C-2 (4) | D-3 (0, 2) | E-2 (730) E-4 (100) |
| 実施例4 | A-3 (95) | B-2 (5) | C-I (5) | D-1 (0.3) | E-1 (790) E-3 (60) |
| 実施例5 | A-4 (94) | B-1 (5) | C-3 (6) | D-2 (0, 3) | E-1 (790) E-3 (60) |
| 実施例6 | A-5 (90) | B-1 (2,5) | C-I (10) | D-2 (0, 2) | E-2 (430) E-4 (100) |
| 比較例1 | A-1 (100) | B-1 (4) | | D-1 (0, 3) | E-1 (790) E-3 (60) |
| 比較例2 | A-1 (100) | B-2 (5) | | D-2 (0,3) | E-1 (790) E-3 (60) |
| 比較例3 | A-2 (100) | B-3 (2) B-4 (3) | | D-3 (0, 2) | E-2 (730) E-4 (100) |
| 比較例4 | A-3 (100) | B-2 (5) | | D-1 (0.3) | E-1 (790) E-8 (80) |
| 比較例5 | A-4 (100) | B-1 (5) | | D-2 (0, 3) | E-1 (790) E-3 (60) |

| | レジスト被膜 | 基板の種類 | РВ | | PEB | |
|-------|----------|--------|---------|-------|---------|-------|
| | の順厚 (μπ) | | 温度 (°C) | 時間(砂) | 温度 (°C) | 時間(炒) |
| 実施例1 | 0, 34 | ARC25 | 130 | 90 | 130 | 90 |
| 実施例 2 | 0, 34 | SiON | 130 | 90 | 130 | 90 |
| 実施例3 | 0.34 | ARC25 | 130 | 90 | 130 | 90 |
| 実施例4 | 0. 34 | ARC25 | 130 | 90 | 130 | 90 |
| 実施例5 | 0, 34 | ARC25 | 130 | 90 | 130 | 90 |
| 実触例 8 | 0, 34 | ARC25 | 130 | 90 | 130 | 90 |
| 比較例1 | 0,84 | ARC 25 | 130 | 90 | 130 | 90 |
| 比較例 2 | 0.34 | ARC 25 | 130 | 90 | 130 | 90 |
| 比較例3 | 0.34 | ARC 25 | 130 | 90 | 130 | 90 |
| 比較例4 | 0, 34 | ARC 25 | 130 | 90 | 130 | 90 |
| 比較例5 | 0.34 | ARC25 | 130 | 90 | 130 | 90 |

[0294]

【表3】

表 3_

| | 放射線透過率 (193mm,%) | 感度 (J/m ²) | 球密線幅差 (nm) | 解像度 (μm) |
|-------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 実施例1 | 79 | 254 | 15 (良好) | 0, 18 |
| 実施例2 | 72 | 246 | 8 (良奸) | 0. 16 |
| 実施例3 | . 75 | 251 | 12 (良好) | 0. 16 |
| 実施例4 | 78 | 229 | 11 (良好) | 0.16 |
| 実施例 5 | 71 | 248 | 9 (良籽) | 0. 16 |
| 実施例 8 | 69 | 120 | 20 (良纤) | 0, 15 |
| 比較例1 | 77 | 254 | 25 (不良) | - |
| 比較例2 | 71 | 247 | 22 (不良) | |
| 比較例3 | 73 | 250 | 31 (不良) | |
| 比較例 4 | 72 | 227 | 34 (不良) | |
| 比較例5 | 70 | 245 | 23 (不良) | |

[0295]

放射線、例えばArFエキシマレーザー(波長193n50 れる遠紫外線に感応する化学増幅型レジストとして、特

m)、KrFエキシマレーザー(波長248nm)ある 【発明の効果】本発明の感放射線性樹脂組成物は、活性 いはF. エキシマレーザー(波長157nm)に代表さ

に、ライン・アンド・スペースパターンのスペース幅が 広い場合にも、微細なラインパターンを形成でき、また 準密集領域(例えば1L1.5S程度)までのピッチサ イズにおいても、ライン間の近接効果による大きな線幅 変動を示さないという特徴を有し、しかも放射線に対する透明性、感度、解像度等にも優れており、今後さらに 微細化が進むと予想される半導体デバイスの製造に極め て好適に使用することができる。

120

フロントページの続き

(72)発明者 石井 寛之

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

(72)発明者 梶田 徹

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 F 夕一ム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA04 AB16 AC04 AC05 AC06 AC08 AD03 BE00

BE10 BG00 CB14 CB41 CB55

CA01 CA04 CA05 CA06 JA38

FA17

4J100 AL08P AL08Q BA03Q BA04Q BA05Q BA06Q BA11P BA11Q BA16Q BA40Q BC08Q BC09Q BC12Q BC53P BC58P BC84P

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| ☐ BLACK BORDERS |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.